

Список використаних джерел

1. Acousto-defect interaction in irradiated and non-irradiated silicon n^+ - p structure / O. Ya. Olikh, A. M. Gorb, R. G. Chupryna, O. V. Pristay-Fenenkov // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Apr. — Vol. 123, no. 16. — P. 161573.
2. Olikh, O.Ya. Acoustically driven degradation in single crystalline silicon solar cell / O.Ya. Olikh // *Superlattices Microstruct.* — 2018. — May. — Vol. 117. — Pp. 173–188.
3. Olikh, Oleg. On the mechanism of ultrasonic loading effect in silicon-based Schottky diodes / Oleg Olikh, Katerina Voytenko // *Ultrasonics*. — 2016. — Mar. — Vol. 66, no. 1. — Pp. 1–3.
4. Effect of ultrasound on reverse leakage current of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo, Ja. M. Olikh // *Journal of Semiconductors*. — 2016. — Dec. — Vol. 37, no. 12. — P. 122002.
5. Olikh, O. Ya. Review and test of methods for determination of the Schottky diode parameters / O. Ya. Olikh // *J. Appl. Phys.* — 2015. — Jul. — Vol. 118, no. 2. — P. 024502.
6. Olikh, O. Ya. Ultrasound influence on I-V-T characteristics of silicon Schottky barrier structure / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko, R. M. Burbelo // *J. Appl. Phys.* — 2015. — Jan. — Vol. 117, no. 4. — P. 044505.
7. Olikh, Oleg. Reversible influence of ultrasound on γ -irradiated Mo/n-Si Schottky barrier structure / Oleg Olikh // *Ultrasonics*. — 2015. — Feb. — Vol. 56. — Pp. 545–550.
8. Особливості дислокаційного полінання ультразвуку в безсубілочних кристалах Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te / I. О. Лисюк, Я. М. Оліх, О. Я. Оліх, Г. В. Бекетов // УФЖК. — 2014. — Т. 59, № 1. — С. 50–57.
9. Olikh, O. Ya. Non-Monotonic γ -Ray Influence on Mo/n-Si Schottky Barrier Structure Properties / O. Ya. Olikh // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2013. — Feb. — Vol. 60, no. 1. — Pp. 394–401.
10. Olikh, O. Я. Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар'єром Шотки залишно від дози γ -опромінення / О. Я. Оліх // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології*. — 2013. — Т. 10, № 1. — С. 47–55.
11. Оліх, О. Я. Вплив ультразвукового нагруження на протекання тока в структурах Mo/n- n^+ -Si з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх // *Фізика і технологія пілотупроводників*. — 2013. — Т. 47, № 7. — С. 979–984.
12. Оліх, О. Я. Особливості перенесення заряду в структурах Mo/n-Si з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх // УФЖК. — 2013. — Т. 58, № 2. — С. 126–134.
13. Оліх, О. Я. Особенности динамических акустоиндированных изменений фотоэлектрических параметров кремниевых солнечных элементов / О. Я. Оліх // *Фізика і технологія пілотупроводників*. — 2011. — Т. 45, № 6. — С. 816–822.
14. Оліх, Я. М. Інформаційний чинник акустичної дії на структуру дефектних комплексів у напівпровідниках / Я. М. Оліх, О. Я. Оліх // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології*. — 2011. — Т. 2(8), № 2. — С. 5–12.
15. Оліх, О. Я. Особливості впливу нейтронного опромінення на динамічну акусто-дефектну взаємодію у кремнієвих сонячних елементах / О. Я. Оліх // УФЖК. — 2010. — Т. 55, № 7. — С. 770–776.
16. Ultrasonically Recovered Performance of γ -Irradiated Metal-Silicon Structures / A.M. Gorb, O.A. Korotchenkov, O.Ya Olikh, A.O. Podolian // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2010. — June. — Vol. 57, no. 3. — Pp. 1632–1639.
17. Оліх, О. Я. Изменение активности рекомбинационных центров в кремнієвих р-п-структуратах в условиях акустического нагружения / О. Я. Оліх // *Фізика і технологія пілотупроводників*. — 2009. — Т. 43, № 6. — С. 774–779.

18. *Olikh, O. Я.* Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустично-то навантаження мегагертового діапазону / О. Я. Оліх, Р. М. Бурбело, М. К. Хіндерс // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології*. — 2007. — Т. 4, № 3. — С. 40–45.
19. *Olikh, O.Ya.* The Dynamic Ultrasound Influence on Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p-n Structures / O.Ya. Olikh, R. Burbelo, M. Hinders // *Semiconductor Defect Engineering – Materials, Synthetic, Structures and Devices II* / Ed. by S. Ashok, P. Kiesel, J. Chevallier, T. Ogino. — Vol. 994 of *Materials Research Society Symposium Proceedings*. — Warrendale, PA: 2007. — Pr. 269–274.
20. *Оліх, О. Я.* Акустостимулюванні корекції волти–амперних характеристик арсенид–галієвих структур з контактом Шоттки / О. Я. Оліх, Т. Н. Пинчук // *Письма в Журнал Технической Физики*. — 2006. — Т. 32, № 12. — С. 22–27.
21. *Конакова, Р.В.* Вплив микроволнової обробки на рівень остаточної деформації та параметри глибоких рівнів монокристалів карбіда кремнія / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Оліх // *Фізика та хімія обробки матеріалів*. — 2005. — № 2. — С. 19–22.
22. *Конакова, Р.В.* Вплив микроволнової обробки на глибокі рівні монокристалів GaAs та SiC / Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.Я. Оліх // *Петербургский журнал электроники*. — 2004. — № 1. — С. 20–24.
23. *Olikh, Ja. M.* Active ultrasound effects in the future usage in sensor electronics / Ja. M. Olikh, O.Ya. Olikh // *Сенсорна електроніка і мікросистемні технології*. — 2004. — Т. 1, № 1. — С. 19–29.
24. *Olikh, O.Ya.* Acoustoelectric transient spectroscopy of microwave treated GaAs-based structures / O.Ya. Olikh // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2003. — Vol. 6, no. 4. — Pr. 450–453.

25. *Оліх, О.Я.* Акустостимульовані динамічні ефекти в сонячних елементах на основі кремнію / О.Я. Оліх // *Вісник Київського університету. Сер.: Фізико-математичні науки*. — 2003. — № 4. — С. 408–414.
26. *Оліх, О. Я.* Ефекти активного ультразвуку в напівпровідникових кристалах / О. Я. Оліх // 1-а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Одеса, Україна. — Т. 1. — Одеса: 2002. — С. 80.
27. Вплив СВЧ облучення на остаточний рівень внутрішніх механіческих напруженостей та параметри глибоких рівнів в эпітаксіальних структурах GaAs / Р. В. Конакова, А. Б. Камалов, О. Я. Оліх та ін. // Труды III международной конференции «Радиационно-терміческі ефекти и процессы в неорганіческих матеріалах», Томск, Россия. — Томск: 2002. — С. 338–339.
28. *Оліх, О. Я.* Про роль теплових та деформаційних механізмів дії ультразвуку на роботу кремнієвих сонячних елементів / О. Я. Оліх // Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМСТ-1», Одеса, Україна. Тези доповідей. — Одеса: 2004. — С. 163.
29. *Olikh, O.* Investigation of microwave treated epitaxial GaAs structures by acoustoelectric method / O. Olikh // 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint 50th Anniversary Conference. Montreal, Canada. Abstracts. — Montreal: 2004. — Pr. 230–231.
30. *Оліх, О. Я.* Вплив СВЧ облучення на остаточний рівень внутрішніх механіческих напруженостей та параметри глибоких рівнів в эпітаксіальних структурах GaAs / О. Я. Оліх // Труды дев'ятої міжнародної научно-технической конференции «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники», Дивноморське, Россия. — Дивноморськ: 2004. — С. 278–279.
31. Influence of acoustic wave on forming and characteristics of silicon p-n junction / J. Olikh, A. Evtukh, B. Romanyuk, O. Olikh // 2005 IEEE International Ultrasonics Symposium and Short Courses. Rotterdam, Netherlands. Abstracts. — Rotterdam: 2005. — P. 542.

32. *Olikh, O.* Dynamic ultrasound effects in silicon solar cell / O. Olikh, R. Burbelo, Hinders M. // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. — Vienna: 2007. — P. 94.
33. *Olikh, O.* Influence of the ultrasound treatment on Au-TiB-n-n⁺-GaAs structure electrical properties / O. Olikh // 2007 International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna, Austria. — Vienna: 2007. — P. 94.
34. *Olikh, O.* The Dynamic Ultrasound Influence on Diffusion and Drift of the Charge Carriers in Silicon p-n Structures / O. Olikh, R. Burbelo, M. Hinders // MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F: Semiconductor Defect Engineering — Materials, Synthetic Structures, and Devices II. San Francisco, USA. — San Francisco: 2007. — P. 3.11.
35. *Olikh, O. Я.* Робота кремнієвих сонячних елементів в умовах акустичного півантаження метагерцового діапазону / О. Я. Оліх // III Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-3, Одеса, Україна. Тези доповідей. — Одеса: 2007. — С. 322.
36. *Olikh, O. Я.* Вплив ультразвукової обробки на вольт-амперні характеристики опромінених кремнієвих структур / О. Я. Оліх, А. М. Горб // VI Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. — Дрогобич: 2008. — С. 114.
37. *Olikh, O. Я.* Акустичні збурення дефектної підсистеми кремнієвих p-n-структур / О. Я. Оліх // VI Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. — Дрогобич: 2008. — С. 174.
38. *Olikh, O. Я.* Особливості механізму ультразвукового впливу на фото-електричний струм у нейтронно-опромінених Si-p-n-структурах / О. Я. Оліх // IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, Запоріжжя, Україна. Тези доповідей. — Т. 2. — Запоріжжя: 2009. — С. 59.
39. *Olikh, Я. М.* Про можливості практично-го застосування ультразвуку для керування характеристиками перетворювачів сонячної енергії / Я. М. Оліх,

- О. Я. Оліх // Четверга міжнародна науково-практична конференція «Матеріали електронної техніки та сучасні інформаційні технології», Кременчуцьк, Україна. Тези доповідей. — Кременчуцьк: 2010. — С. 147-148.
40. *Olikh, O. Я.* Немонотонний вплив γ-опромінення на електричні властивості кремнієвих структур з бар'єром Шотки / О. Я. Оліх, С. В. Онисок // VII Міжнародна школа-конференція «Актуальні проблеми фізики напівпровідників», Дрогобич, Україна. Тези доповідей. — Дрогобич: 2010. — С. 171-172.
41. *Olikh, O. Я.* Особливості динамічного ультразвукового впливу на γ-опромінені кремнієvi n – s – структури / О. Я. Оліх, С. В. Онисок // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників УНКФН-5, Ужгород, Україна. — Ужгород: 2011. — С. 339-340.
42. *Olikh, O. Я.* Вплив ультразвуку на термоемісійні процеси в Mo/n-n⁺-Si структурах / О. Я. Оліх // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фізики», Тернопіль, Україна. — Тернопіль: 2012. — С. 101-103.
43. *Olikh, O. Ya.* Reversible Alteration of Reverse Current in Mo/n-Si Structures Under Ultrasound Loading / O. Ya. Olikh, Ya. M. Olikh // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем. Матеріали XIV Міжнародної конференції / Під ред. Д.М. Фреїка. — Івано-Франківськ: видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. — С. 322. — Дрогобич: 2008. — С. 174.
44. *Olikh, O. Ya.* Modification of reverse current in the Mo/n-Si structures under conditions of ultrasonic loading / O. Ya. Olikh, K. V. Voytenko // VIII International school-conference «Actual problems of semiconductor physics», Drohobych, Ukraine. Abstract book. — Drohobych: 2013. — Pp. 101-102.
45. *Olikh, Ya. M.* About acoustical-stimulated a self-organization defect structures in semiconductor during ion implantation / Ya. M. Olikh, O. Ya. Olikh // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», Bukovel, Ukraine. Abstract book. — Bukovel: 2013. — P. 240.

- II Всеукраїнський науково-практичний конференції MEICS-2017. Дніпро, Україна. — Дніпро: 2017. — С. 302–303.
46. *Olikh, O. Я.* Вплив γ -опромінення на механізм перенесення заряду в структурах Mo/n-Si / О. Я. Оліх // VI Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-6. Чернівці, Україна. Тези доповідей. — Чернівці: 2013. — С. 121–122.
47. *Olikh, Ya.* New approach to ultrasonic absorption in subgrain-free Cd_{0,2}Hg_{0,8}Te crystals / Ya. Olikh, I. Lysyuk, O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. — Chicago: 2014. — Рр. 439–440.
48. *Olikh, O.* Ultrasonically induced effects in Schottky barrier structure depending on a γ -irradiation / O. Olikh // 2014 IEEE International Ultrasonics Symposium. Chicago, Illinois, USA. Abstract book. — Chicago: 2014. — Рр. 645–646.
49. *Olikh, O. Я.* Характеризація γ -опромінених кремнієвих p-n-структур методом диференційних коефіцієнтів / О. Я. Оліх, О. В. Пристай // 6-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка і мікроконтролери», Одеса, Україна. Тези доповідей. — Одеса: 2014. — С. 193.
50. *Olikh, O.Ya.* Ultrasonic Loading Effects on Silicon-based Schottky Diodes / O.Ya.Olikh, K. V. Voytenko // 2015 International Congress on Ultrasonics. Metz, France. Abstract book. — Metz: 2015. — Р. 225.
51. *Olikh, O. Я.* Порівняння ефективності методів визначення параметрів діодів Шотки / О. Я. Оліх // Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: Проблеми IV-ї міжнародної конференції. Київ, Україна. — Київ: 2015. — С. 32–34.
52. Ультразвукова модифікація стимульованого фононами тунелювання у кремнієвих діодах Шотки / О. Я. Оліх, К. В. Войтенко, Р. М. Бурбо, Я. М. Оліх // VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-7. Дніпро, Україна. Тези доповідей. — Дніпро: 2016. — С. 190–191.
53. *Olikh, O. Я.* Акусто-гетерована модифікація властивостей кремнієвих фотодіодів / О. Я. Оліх // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем. Тези доповідей на
54. Ultrasonic treatment of GaP and GaAs / D. Klimm, B. Tippelt, P. Paufler, P. Haasen // *Phys. Status Solidi A*. — 1993. — Aug. — Vol. 138, no. 2. — Рр. 517–521.
55. Механізм изменения подвижности носителей заряда при ультразвуковой обработке полупроводникових твердых растворов / П.И. Баранский, А.Е. Беляев, С.М. Комиренко, Шевченко Н.В. // *Фізика твердого тела*. — 1990. — Т. 32, № 7. — С. 2159–2161.
56. *Ostapenko, S.* Defect passivation using ultrasound treatment: fundamentals and application / S. Ostapenko // *Applied Physics A: Materials Science & Processing*. — 1999. — Aug. — Vol. 69, no. 2. — Рр. 225–232.
57. Activation of luminescence in polycrystalline silicon thin films by ultrasound treatment / J. Koslka, S. Ostapenko, T. Ruf, J. M. Zhang // *Appl. Phys. Lett.* — 1996. — Oct. — Vol. 69, no. 17. — Рр. 2537–2539.
58. *Ostapenko, Sergei S.* Mechanism of Ultrasonic Enhanced Hydrogenation in Poly-Si Thin Films / Sergei S. Ostapenko // Defects in Semiconductors 19. — Vol. 258 of *Materials Science Forum*. — Trans Tech Publications, 1997. — 12. — Рр. 197–202.
59. *Заверюхин, Б.Н.* Изменение коэффициента отражения излучения от поверхности полупроводников в спектральном диапазоне $\lambda = 0.2 \div 20$ $\mu\text{м}$ под воздействием ультразвуковых волн / Б.Н. Заверюхин, Н.Н. Заверюхина, О.М. Турсункулов // *Листья 6 Журнала технической физики*. — 2002. — Т. 28, № 18. — С. 1–12.
60. Акустостимулированное изменение плотности и энергетического спектра поверхностных состояний в монокристаллах р-кремния / Н.Н. Заверюхина, Е.Б. Заверюхина, С.М. Власов, Б.Н. Заверюхин // *Листья 6 Журнала технической физики*. — 2008. — Т. 34, № 6. — С. 36–42.

61. Акустимулированная адгезия медных шненок к кремнию / Б.Н. Заверохин, Х.Х. Исмагилов, Р.А. Мумлинов и др. // *Письма в журнал технической физики*. – 1996. – Т. 22, № 15. – С. 25–27.
62. *Островский, И.В. Стимулированное ультразвуком низкотемпературное перераспределение примесей в кремнии / И.В. Островский, А.Б. Надточий, А.А. Подолян // Физика и техника полупроводников.* – 2002. – Т. 36, № 4. – С. 389–391.
63. *Островский, И.В. Образование поверхностного упрочненного слоя в бездислокационном кремнии при ультразвуковой обработке / И.В. Островский, Л.Л. Стебленко, А.Б. Надточий // Физика и техника полупроводников.* – 2000. – Т. 34, № 3. – С. 257–260.
64. Влияние ультразвуковой обработки на экзитонную и примесную люминесценцию CdTe / Б.Н. Бабенков, С.И. Горбань, И.Я. Городецкий и др. // *Физика и техника полупроводников*. – 1991. – Т. 25, № 7. – С. 1243–1245.
65. Безактивационное движение доноров под действием ультразвука в кристаллах CdS / Л.В. Борковская, Б.Р. Джумаев, И.А. Дроздова и др. // *Физика твердого тела*. – 1995. – Т. 37, № 9. – С. 2745–2748.
66. Athermal Motion of Donors under Ultrasound in CdS Crystals / Moissei K. Sheinkman, L.V. Borkovskaya, B.R. Dzhumaev et al. // *Defects in Semiconductors* 18 / Ed. by M. Suezawa, H. Katayama-Yoshida. – Vol. 196 of *Materials Science Forum*. – Trans Tech Publications, 1995. – 11. – Pp. 1467–1470.
67. Redistribution of mobile point defects in CdS crystals under ultrasound treatment / L.V. Borkovska, M.P. Baran, N.O. Korsunskaya et al. // *Physica B: Condensed Matter*. – 2003. – Dec. – Vol. 340–342. – Pp. 258–262.
68. Механизмы изменения электрических и фотоэлектрических свойств монокристаллов твердых растворов $Zn_xCd_{1-x}Te$ под действием ультразвука / Г. Гарипьев, И.Я. Городецкий, Б.Р. Джумаев и др. // *Физика и техника полупроводников*. – 1991. – Т. 25, № 3. – С. 409–412.
69. Ultrasound treatment for porous silicon photoluminescence enhancement / A. El-Bahar, S. Stolyarova, A. Chack et al. // *Phys. Status Solidi A*. – 2003. – May. – Vol. 197, no. 2. – Pp. 340–344.
70. Клименко, И.А. Влияние акустической обработки на фотопроводимость кристаллов селенида цинка / И.А. Клименко, В.П. Мигаль // *Письма в журнал технической физики*. – 1999. – Т. 25, № 24. – С. 24–29.
71. Влияние ультразвуковой обработки на фотоэлектрические и люминесцентные свойства кристаллов ZnSe / Е.М. Зобов, М.Е. Зобов, Ф.С. Габибов и др. // *Физика и техника полупроводников*. – 2008. – Т. 42, № 3. – С. 282–285.
72. Заверохина, Н.Н. Акустостимулированное изменение коэффициента поглощения арсенида галлия в диапазоне длин волн $\lambda = 0.81 \div 1.77\text{ }\mu\text{m}$ / Н.Н. Заверохина, Е.Б. Заверохина, Б.Н. Заверохин // *Письма в журнал технической физики*. – 2007. – Т. 33, № 9. – С. 1–10.
73. Влияние ультразвуковой обработки на энергетический спектр электронных ловушек монокристаллов n-GaAs / Ф.С. Габибов, Е.М. Зобов, М.Е. Зобов и др. // *Письма в журнал технической физики*. – 2015. – Т. 41, № 8. – С. 9–16.
74. Effect of ultrasound treatment on the optical properties of C_{60} fullerene films / U. Ritter, P. Scharff, V.V. Kozaichenko et al. // *Chem. Phys. Lett.* – 2008. – Dec. – Vol. 467, no. 1–3. – Pp. 77–79.
75. Wosinski, T. Transformation of native defects in bulk GaAs under ultrasonic vibration / T. Wosinski, A. Makosa, Z. Witczak // *Semicond. Sci. Technol.* – 1994. – Nov. – Vol. 9, no. 11. – Pp. 2047–2052.
76. Ultrasound regeneration of EL2 centres in GaAs / I. A. Buyanova, S. S. Ostapenko, M. K. Sheinkman, M. Murrikov // *Semicond. Sci. Technol.* – 1994. – Feb. – Vol. 9, no. 2. – Pp. 158–162.

77. Influence of Ultrasound Vibrations on the Stable-Metastable Transitions of EL2 Centers in GaAs / I.A. Buyanova, Sergei S. Ostapenko, A.U. Savchuk, Moisei K. Sheinkman // Defects in Semiconductors 17 / Ed. by Helmut Heinrich, Wolfgang Jantsch. — Vol. 143 of *Materials Science Forum*. — Trans Tech Publications, 1993. — 10. — Pp. 1063–1068.
78. Онанко, А.П. Влияние ультразвуковой обработки на внутреннее трение в кремнии / А.П. Онанко, А.А. Половин, И.В. Островский // *Письма в журнал механической физики*. — 2003. — Т. 29, № 15. — С. 40–44.
79. Ostapenko, S. S. Change of minority carrier diffusion length in polycrystalline silicon by ultrasound treatment / S. S. Ostapenko, L. , Jastrzebski, B. Sopori // *Semicond. Sci. Technol.* — 1995. — Nov. — Vol. 10, no. 11. — Pp. 1494–1500.
80. Ostapenko, S. S. Ultrasound stimulated dissociation of Fe–B pairs in silicon / S. S. Ostapenko, R. E. Bell // *J. Appl. Phys.* — 1995. — May. — Vol. 77, no. 10. — Pp. 5458–5460.
81. Increasing short minority carrier diffusion lengths in solar-grade polycrystalline silicon by ultrasound treatment / S. S. Ostapenko, L. Jastrzebski, J. Lagowski, B. Sopori // *Appl. Phys. Lett.* — 1994. — Sep. — Vol. 65, no. 12. — Pp. 1555–1557.
82. Баранский, И.И. Роль малоугловых границ в изменении электропроводности кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$ под действием ультразвука / П.И. Баранский, К.А. Мысливец, Я.М. Олик // *Физика твердого тела*. — 1989. — Т. 31, № 9. — С. 278–281.
83. Мысливец, К.А. Роль малоугловых границ в изменении рекомбинационной активности глубоких центров кристаллов $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ под действием ультразвука / К.А. Мысливец, Я.М. Олик // *Физика твердого тела*. — 1990. — Т. 32, № 10. — С. 2912–2916.
84. Любченко, А.В. Рекомбинация носителей через акцепторные уровни собственных дефектов в кристаллах $n-Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых ультразвуковой обработке / А.В. Любченко, К.А. Мысливец, Я.М. Олик // *Физика и техника полупроводников*. — 1990. — Т. 24, № 1. — С. 171–174.
85. Layered structure formation in $Hg_{1-x}Cd_xTe$ films after high-frequency sonication / R.K. Savkina, F.F. Sizov, A.B. Smirnov, V.V. Tetyorkin // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2006. — Vol. 9, no. 4. — Pp. 31–35.
86. Олик, Я.М. Акустостимулированное плавление шума I/F в «субблочниках» кристаллах $Cd_{0.2}Hg_{0.8}Te$ / Я.М. Олик, Ю.Н. Шавлюк // *Физика твердого тела*. — 1996. — Т. 38, № 11. — С. 3365–3371.
87. Savkina, R. K. The effect of high-frequency sonication on charge carrier transport in LPE and MBE $HgCdTe$ layers / R. K. Savkina, A. B. Smirnov, F.F. Sizov // *Semicond. Sci. Technol.* — 2007. — Feb. — Vol. 22, no. 2. — Pp. 97–102.
88. Savkina, R.K. Sonic–Stimulated Change of the Charge Carrier Concentration in $n-Cd_xHg_{1-x}Te$ Alloys with Different Initial State of the Defect Structure / R.K. Savkina, O.I. Vlasenko // *Phys. Status Solidi B*. — 2002. — Mar. — Vol. 229, no. 1. — Pp. 275–278.
89. Стимулированные ультразвуком структурные изменения в напряженных гетероструктурах / В.Ф. Бритун, Н.Я. Горилько, В.А. Корнная и др. // *Физика твердого тела*. — 1991. — Т. 33, № 8. — С. 2340–2344.
90. Влияние акустических колебаний на гензорезистивный эффект в пленках $p-Ge$ / Н.Д. Василенко, В.В. Гордиенко, В.Л. Корчная и др. // *Письма в журнал технической физики*. — 1990. — Т. 16, № 9. — С. 32–36.
91. Злобский, А.П. Влияние ультразвука на точечные дефекты в структурах $Si-SiO_2$ / А.П. Злобский, Д.И. Кротман, Шейнкман М.К. // *Журнал технической физики*. — 1989. — Т. 59, № 8. — С. 131–134.

92. Влияние ультразвукового воздействия на генерационные характеристики границы раздела кремний–диоксид кремния / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Л.Г. Лигай, О.Ю. Шукина // *Письма в журнал технической физики*. — 2003. — Т. 29, № 9. — С. 83–88.
93. Власов, С.И. Влияние ультразвуковой обработки на генерационные характеристики границы раздела полупроводник–стекло / С.И. Власов, А.В. Овсянников, Б.Н. Заверюхин // *Письма в журнал технической физики*. — 2009. — Т. 35, № 7. — С. 41–45.
94. Влияние ультразвука на фотоэлектрические характеристики тонкопленочных электролюминесцентных структур / В.Г. Акульшин, В.В. Дякин, В.Н. Лысенко, В.Е. Родионов // *Журнал технической физики*. — 1989. — Т. 59, № 10. — С. 156–158.
95. Enhanced hydrogenation in polycrystalline silicon thin films using low-temperature ultrasound treatment / S. Ostapenko, L. Jastrzebski, J. Lagowski, R. K. Smeltzer // *Appl. Phys. Lett.* — 1996. — May. — Vol. 68, no. 20. — Pp. 2873–2875.
96. Effect of ultrasonic treatment on the defect structure of the Si–SiO₂ system / D. Kropman, V. Seeman, S. Dolgov, A. Medvids // *Phys. Status Solidi C*. — 2016. — Oct. — Vol. 13, no. 10–12. — Pp. 793–797.
97. Акустостимулированное расширение коротковолнового диапазона стеклоТВЧ чувствительности AlGaAs/GaAs-солнечных элементов / Е.Б. Заверюхина, Н.Н. Заверюхина, Л.Н. Лезилова и др. // *Письма в журнал технической физики*. — 2005. — Т. 31, № 1. — С. 54–66.
98. Effect of ultrasound treatment on CuInSe₂ solar cells / I. Dimstoffer, W. Burkhardt, B. K. Meyer et al. // *Solid State Commun.* — 2000. — Sep. — Vol. 116, no. 2. — Pp. 87–91.
99. Davletova, A. Open-circuit voltage decay transient in dislocation-engineered Si p-n junction / A. Davletova, S. Zh. Karazhanov // *Journal of Physics D: Applied Physics*. — 2008. — Aug. — Vol. 41, no. 16. — P. 165107.
100. Davletova, A. A study of electrical properties of dislocation engineered Si processed by ultrasound / A. Davletova, S. Zh. Karazhanov // *Journal of Physics and Chemistry of Solids*. — 2009. — June. — Vol. 70, no. 6. — Pp. 989–992.
101. Сукач, А.В. Трансформация электрических свойств InAs p-n-переходов в результате ультразвуковой обработки / А.В. Сукач, В.В. Тетеркин // *Письма в журнал технической физики*. — 2009. — Т. 35, № 11. — С. 67–75.
102. Acoustic-stimulated relaxation of GaAs_{1-x}P_x LEDs electroluminescence intensity / O.V. Konoreva, M.V. Lytvchenko, Ye.V. Malyi et al. // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2016. — Vol. 19, no. 1. — Pp. 34–38.
103. Mirsagatov, Sh. A. Ultrasonic Annealing of Surface States in the Heterojunction of a p-Si/n-CdS/n+–CdS Injection Photodiode / Sh. A. Mirsagatov, I. B. Sapayeva, Zh.T. Nazarov // *Inorganic Materials*. — 2015. — Dec. — Vol. 51, no. 1. — Pp. 1–4.
104. Electrophysical and Photoelectric Properties of Injection Photodiode Based on pSi-nCdS-In Structure and Influence of Ultrasonic Irradiation on them / Sh. A. Mirsagatov, I.B. Sapayev, Sh. R. Valieva, D. Babajanyan // *Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics*. — 2015. — Mar. — Vol. 9, no. 6. — Pp. 834–843.
105. Пашаев, И.Г. Влияние различных обработок на свойства диодов Шоттки / И.Г. Пашаев // *Физика и техника полупроводников*. — 2012. — Т. 46, № 8. — С. 1108–1110.
106. Pashayev, I. The Influence of Ultrasonic Treatment on the Properties of Schottky Diodes / I. Pashayev // *Open Journal of Acoustics*. — 2013. — Vol. 3, no. 3A. — Pp. 9–12.
107. Tagaev, M.B. Effect of Ultrasonic Treatment of Silicon Impatt Diodes, Power Schottky Diodes and Zener Diodes on their Electrical Characteristics / M.B. Tagaev // *УФДК*. — 2000. — Т. 45, № 3. — С. 364–367.

108. Влияние ультразвуковой обработки на деформационные эффекты и структуру локальных центров в подложке и приконтактных областях структур M/h-n⁺-GaAs (M=Pt, Cr, W) / И.Б. Ермолович, В.В. Миленин, Р.В. Конакова и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 1997. — Т. 31, № 4. — С. 503–508.
109. Островский, И.В. Влияние ядерной радиации и ультразвука на проводимость кремния / И.В. Островский, О.А. Коротченков // *Журнал технической физики*. — 1986. — Т. 56, № 11. — С. 2283–2284.
110. Подолян, А.А. Восстановление времени жизни носителей заряда под воздействием ультразвуковой обработки в γ-облученном кремни / А.А. Подолян, А.Б. Надточий, О.А. Коротченков // *Письма в журнал технической физики*. — 2012. — Т. 38, № 9. — С. 15–22.
111. Подолян, А.А. Влияние ультразвука на отжиг радиационных дефектов в кремни при комнатных температурах / А.А. Подолян, В.И. Хирич // *Письма в журнал технической физики*. — 2005. — Т. 31, № 10. — С. 11–16.
112. Олих, Я.М. Акустостимулированное преобразование радиационных дефектов в γ-облученных кристаллах кремния n-типа / Я.М. Олих, Н.Д. Тимошко, А.П. Долголенко // *Письма в журнале технической физики*. — 2006. — Т. 32, № 13. — С. 67–73.
113. Олих, Я.М. О влиянии ультразвука на отжиг радиационных дефектов в нейтронно-легированном германии / Я.М. Олих, Н.И. Карась // *Физика и техника полупроводников*. — 1991. — Т. 30, № 8. — С. 1455–1459.
114. Thermoacoustic annealing of radiation-induced defects in indium-phosphide crystal / Ya.M. Olikh, V.P. Taratchnik, I.I. Tichyna, Vernidub R.M. // The proceeding of 5th conference «Acoustoelectronics' 91». — 1991. — May. — Pp. 95–96. — Varna, Bulgaria.
115. Radiation defects manipulation by ultrasound in ionic crystals / I. Ostrovskii, N. Ostrovskaya, O. Korotchenkov, J. Reidy // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2005. — Dec. — Vol. 52, no. 6. — Pp. 3068–3073.

116. Влияние ультразвука на параметры структур металл–диэлектрик–полупроводник / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Р.А. Муминов и др. // *Письма в журнал технической физики*. — 2000. — Т. 26, № 10. — С. 40–45.
117. Парчинский, П.Б. Исследование влияния ультразвукового воздействия на генерационные характеристики предварительно облученной границы раздела кремний–диоксид кремния / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, Л.Г. Лигай // *Физика и техника полупроводников*. — 2006. — Т. 40, № 7. — С. 829–832.
118. Гусейнов, Н.А. Восстановление фотоэлектрических параметров кремниевых солнечных элементов, облученных γ-квантами ⁶⁰Co, с помощью ультразвуковой обработки / Н.А. Гусейнов, Я.М. Олих, Аскеров Ш.Г. // *Письма в журнал технической физики*. — 2007. — Т. 33, № 1. — С. 38–44.
119. Пашаев, И.Г. Исследование релаксации избыточного тока кремниевых диодов Шоттки / И.Г. Пашаев // *Физика и техника полупроводников*. — 2014. — Т. 48, № 10. — С. 1426–1429.
120. The influence of acoustic-dislocation interaction on intensity of the bound exciton recombination in initial and irradiated GaAsP LEDs structures / O.V. Konoreva, Ya.M. Olikh, M.B. Pinkovska et al. // *Superlattices Microstruct.* — 2017. — Vol. 102. — Pp. 88–93.
121. Литовченко, В.Г. Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно-променевому синтезі / В.Г. Литовченко, В.П. Мельник, Б.М. Романюк // *УФЖ*. — 2015. — Т. 60, № 1. — С. 66–75.
122. Mechanisms of Silicon Amorphization at the Ultrasound Action during Ion Implantation / B. Romanyuk, D. Kruger, V. Melnik ta in. // *УФЖ*. — 2001. — Т. 46, № 2. — С. 191–195.
123. Peculiarities of the Defect Formation in the Near-surface Layers of Si Single Crystals under Acoustostimulated Implantation of Ions of Boron and Arsenic / O.I. Gudymenko, V.P. Kladko, V.P. Melnik ta in. // *УФЖ*. — 2008. — Т. 53, № 2. — С. 140–145.

124. Effect of in situ ultrasonic treatment on tungsten surface oxidation / Andriy Romanyuk, Peter Oelhafen, Roland Steiner et al. // *Surf. Sci.* — 2005. — Dec. — Vol. 595, no. 1–3. — Pp. 35–39.
125. Ultrasound-assisted oxidation of tungsten in oxygen plasma: the early stages of the oxide film growth / Andriy Romanyuk, Roland Steiner, Viktor Melnik, Verena Thommen // *Surface and Interface Analysis*. — 2006. — Aug. — Vol. 38, no. 8. — Pp. 1242–1246.
126. Modification of the Si amorphization process by in situ ultrasonic treatment during ion implantation / B. Romanyuk, V. Melnik, Ya. Olikh et al. // *Semicond. Sci. Technol.* — 2001. — May. — Vol. 16, no. 5. — Pp. 397–401.
127. Characteristics of silicon p-n junction formed by ion implantation with in situ ultrasound treatment / V.P. Melnik, Y.M. Olikh, V.G. Popov et al. // *Materials Science and Engineering: B*. — 2005. — Dec. — Vol. 124–125. — Pp. 327–330.
128. Enhanced relaxation of SiGe layers by He implantation supported by in situ ultrasonic treatments / B. Romanjuk, V. Kladko, V. Melnik et al. // *Materials Science in Semiconductor Processing*. — 2005. — Feb. — Vol. 8, no. 1–3. — Pp. 171–175.
129. Influence of in situ ultrasound treatment during ion implantation on amorphization and junction formation in silicon / D. Krüger, B. Romanyuk, V. Melnik et al. // *J. Vac. Sci. Technol. B*. — 2002. — Jul. — Vol. 20, no. 4. — Pp. 1448–1451.
130. Amulevicius, A. Mössbauer studies of Fe–Si–C system structure changes by laser and ultrasound treatment / A. Amulevicius, K. Mazeika, A. Daugvila // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 2000. — Aug. — Vol. 33, no. 16. — Pp. 1985–1989.
131. Kalem, S. Effect of Light Exposure and Ultrasound on the Formation of Porous Silicon / S. Kalem, O. Yavuzcetin, C. Altineller // *Journal of Porous Materials*. — 2000. — Jan. — Vol. 7, no. 1. — Pp. 381–383.
132. Improved electroluminescence performance of ZnS:Cu,Cl phosphors by ultrasonic treatment / Wendeng Wang, Fuqiang Huang, Yujian Xia, Anbao Wang // *J. Lumin.* — 2008. — Feb. — Vol. 128, no. 2. — Pp. 199–204.
133. Ultrasonic-assisted mist chemical vapor deposition of II–oxide and related oxide compounds / Shizuo Fujita, Kentaro Kaneko, Takumi Ikenoue et al. // *Phys. Status Solidi C*. — 2014. — Jul. — Vol. 11, no. 7–8. — Pp. 1225–1228.
134. Romanyuk, A. Influence of in situ ultrasound treatment during ion implantation on formation of silver nanoparticles in silica / A. Romanyuk, V. Spassov, V. Melnik // *J. Appl. Phys.* — 2006. — Feb. — Vol. 99, no. 3. — P. 034314.
135. Jivanescu, M. Influence of in situ applied ultrasound during Si⁺ implantation in SiO₂ on paramagnetic defect generation / M. Jivanescu, A. Romanyuk, A. Stesmans // *J. Appl. Phys.* — 2010. — June. — Vol. 107, no. 11. — P. 114307.
136. Jivanescu, M. Influence of in situ applied ultrasound during Si⁺ implantation in SiO₂ on paramagnetic defect generation / M. Jivanescu, A. Romanyuk, A. Stesmans // *J. Appl. Phys.* — 2007. — Jan. — Vol. 90, no. 1. — P. 013118.
137. Light emission from nanocrystalline silicon clusters embedded in silicon dioxide: Role of the suboxide states / A. Romanyuk, V. Melnik, Y. Olikh et al. // *J. Lumin.* — 2010. — Jan. — Vol. 130, no. 1. — Pp. 87–91.
138. Majhi, Abhijit. Comparative Study of Ultrasound Stimulation and Conventional Heating Methods on the Preparation of Nanosized γ-Al₂O₃ / Abhijit Majhi, G. Pugazhenthi, Anupam Shukla // *Industrial & Engineering Chemistry Research*. — 2010. — Vol. 49, no. 10. — Pp. 4710–4719.
139. Behboudnia, M. Synthesis and characterization of CdSe semiconductor nanoparticles by ultrasonic irradiation / M. Behboudnia, Y. Aziziane kalandaragh // *Materials Science and Engineering: B*. — 2007. — Mar. — Vol. 138, no. 1. — Pp. 65–68.
140. Ultrasonic-assisted chemical reduction synthesis and structural characterization of copper nanoparticles / Nguyen T. Anh-Nga, Nguyen Tuan-Anh, Nguyen Thanh-Quoc, Do Tuong Ha // *AIPI Conference Proceedings*. — 2018. — Vol. 1954, no. 1. — P. 030010.

141. Evolution of CdS:Mn nanoparticle properties caused by pH of colloid solution and ultrasound irradiation / A. I. Savchuk, G. Yu. Rudko, V. I. Fediv et al. // *Phys. Status Solidi C.* — 2010. — Jun. — Vol. 7, no. 6. — Pp. 1510–1512.
142. Effect of particle size on optical and electrical properties in mixed CdS and NiS nanoparticles synthesis by ultrasonic wave irradiation method / V. Mohanraj, R. Jayaprakash, R. Robert et al. // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2016. — Dec. — Vol. 56. — Pp. 394–402.
143. Effect of ultrasonic wave on the syntheses of Au and ZnO nanoparticles by laser ablation in water / N. Takada, A. Fujikawa, N. Koshizaki, K. Sasaki // *Applied Physics A: Materials Science & Processing*. — 2013. — Mar. — Vol. 110, no. 4. — Pp. 835–839.
144. Greenhall, J. Ultrasound directed self-assembly of user-specified patterns of nanoparticles dispersed in a fluid medium / J. Greenhall, F. Guevara Vasquez, B. Raeymakers // *Appl. Phys. Lett.* — 2016. — Mar. — Vol. 108, no. 10. — P. 103103.
145. TAILLAN, Christophe. Nanoscale Self-Organization Using Standing Surface Acoustic Waves / Christophe Tailian, Nicolas Combe, Joseph Morillo // *Phys. Rev. Lett.* — 2011. — Feb. — Vol. 106. — P. 076102.
146. Оліх, Я.М. Прямое наблюдение релаксации проводимости в гамма-облученном кремнии p-типа под влиянием импульсов ультразвука / Я.М. Оліх, Н.Д. Тимошко // *Лісівна та журнал технічної фізики*. — 2011. — Т. 37, № 1. — С. 78–84.
147. Оліх, Я.М. Особливості проглядання струму при ультразвуковому нагантаєнні в сильно компенсованих низькоомних кристалах CdTe:Cl / Я.М. Оліх, М.Д. Тимошко // УФК. — 2016. — Т. 61, № 5. — С. 389–399.
148. Olikh, Ya. M. Reverse ultrasonic changes of electrical conductivity in CdTe:Cl crystals / Ya. M. Olikh, M. D. Tymochko // *Superlattices Microstruct.* — 2016. — Jul. — Vol. 95. — Pp. 78–82.

149. Власенко, А.И. Акустостимулированная активация связанных дефектов в твердых растворах CdHgTe / А.И. Власенко, Я.М. Оліх, Р.К. Савкіна // *Фізика та техніка польових електронів*. — 1999. — Т. 33, № 4. — С. 410–414.
150. Власенко, А.И. Подвижность носителей заряда в кристаллах $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ в условиях динамического ультразвукового нагружения / А.И. Власенко, Я.М. Оліх, Р.К. Савкіна // *Фізика та техніка польових електронів*. — 2000. — Т. 34, № 6. — С. 670–676.
151. Acoustically driven optical phenomena in bulk and low-dimensional semiconductors / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, O.Ya Olikh et al. // *J. Opt. A: Pure Appl. Opt.* — 2001. — July. — Vol. 3, no. 4. — Pp. S82–S86.
152. Оліх, О.Я. Увеличение длины диффузии электронов в кристаллах p -кремния под действием ультразвука / О.Я. Оліх, І.В. Острівський // *Фізика твердого тела*. — 2002. — Т. 44, № 7. — С. 1198–1202.
153. Korotchenkov, O.A. Long-wavelength acoustic-mode-enhanced electron emission from Se and Te donors in silicon / O.A. Korotchenkov, H.G. Grimmliss // *Phys. Rev. B*. — 1995. — Nov. — Vol. 52, no. 20. — Pp. 14598–14606.
154. Мукашев, Б.Н. Метастабильные и бистабильные дефекты в кремнии / Б.Н. Мукашев, Ю.В. Абдуллин, Ю.В. Горелкинский // *Успехи фізических наук*. — 2000. — Т. 170, № 2. — С. 143–155.
155. The Ultrasonics-Induced-Quenching of PPC Related to DX Centers in $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ / A.E. Belyaev, Hans Jürgen von Barthel, M.L. Fille et al. // *Defects in Semiconductors 17* / Ed. by Helmut Heinrich, Wolfgang Jantsch. — Vol. 143 of *Materials Science Forum*. — Trans Tech Publications, 1993. — 10. — Pp. 1057–1062.
156. Процессы дрейфа неравновесных носителей тока в GaAs-фотоприемниках под действием переменной деформации / Б.Н. Заверюхин, Н.Н. Заверюхина, Р.А. Муминов, О.М. Турсункулов // *Лісівна та журнал технічної фізики*. — 2002. — Т. 28, № 5. — С. 75–83.

157. Вплив ультразвуку на вольт-амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs / Б. В. Курілюк, А. М. Горб, О. О. Коротченков, О. Я. Оліх // *Вісник Кіївського університету. Сер.: Фізико-математичні науки.* — 2003. — № 3. — С. 298–300.
158. *Kuryliuk, Iasyl.* Acoustically driven charge separation in semiconductor heterostructures sensed by optical spectroscopy techniques / Vasyl Kuryliuk, Artem Podolian, Oleg Korotchenkov // *Cent. Eur. J. Phys.* — 2009. — Jun. — Vol. 8, no. 1. — Pp. 65–76.
159. Деградаційно-релаксаційні явища в світогізлучаючих $p-n$ -структурах на основі фосфіда галія, стимулюванні ультразвуком / А. Н. Гонтарук, Д. В. Корбутяк, Е. В. Корбут і др. // *Письма в журнал технической физики.* — 1998. — Т. 24, № 64–68. — С. 22–27.
160. *Ostrovskii, I.B.* Акустопоміннення і дефекти кристалів / І.В. Острівський. — К.: Випча школа, 1993. — 223 с.
161. Sonoluminescence and acoustically driven optical phenomena in solids and solid-gas interfaces / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, T. Goto, H.G. Grimeiss // *Physics Reports.* — 1999. — Jan. — Vol. 311, no. 1. — Pp. 1–46.
162. Acoustically driven emission of light in granular and layered semiconductors: recent advances and future prospects / O. A. Korotchenkov, T. Goto, H. G. Grimeiss et al. // *Reports on Progress in Physics.* — 2002. — Jan. — Vol. 65, no. 1. — Pp. 73–97.
163. *Korotchenkov, O. A.* Powder agglomeration patterns at acoustic driving observed by sonoluminescence technique / O. A. Korotchenkov, T. Goto // *J. Appl. Phys.* — 1999. — Jan. — Vol. 85, no. 2. — Pp. 1153–1158.
164. *Ostrovskii, I.V.* Characterization of unstable point defects in crystals / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov // *Solid State Commun.* — 1992. — Apr. — Vol. 82, no. 4. — Pp. 267–270.

165. *Korotchenkov, O.A.* Study on bound exciton dynamics in CdS crystals at acoustic driving / O.A. Korotchenkov, T. Goto // *Physica B: Condensed Matter.* — 1998. — Oct. — Vol. 253, no. 3–4. — Pp. 203–214.
166. *Korotchenkov, O.* Acoustically driven bound exciton lifetimes in CdS crystals / O Korotchenkov, Takenari Goto // *Appl. Phys. Lett.* — 1998. — 04. — Vol. 72, no. Apr. — Pp. 1733–1735.
167. Effect of surface acoustic waves on low-temperature photoluminescence of GaAs / K. S. Zhuravlev, D. V. Petrov, Yu. B. Bolkhovityanov, N. S. Rudaja // *Appl. Phys. Lett.* — 1997. — Jun. — Vol. 70, no. 25. — Pp. 3389–3391.
168. Acoustic driving effect on radiative decays of excitons in ZnSe/ZnS single quantum wells / O. A. Korotchenkov, A. Yamamoto, T. Goto et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 1999. — May. — Vol. 74, no. 21. — Pp. 3179–3181.
169. Acoustically Driven Storage of Light in a Quantum Well / C. Rocke, S. Zimmerman, A. Wixforth et al. // *Phys. Rev. Lett.* — 1997. — May. — Vol. 78. — Pp. 4099–4102.
170. Conversion of bound excitons to free excitons by surface acoustic waves / S. Völk, A. Wixforth, D. Reuter et al. // *Phys. Rev. B.* — 2009. — Oct. — Vol. 80. — P. 165307.
171. The rotation of the polarization plane of quantum-well heterolasers emission under the ultrasonic strain / Liudmila Kulakova, Vladislav Gorelov, Andrey Lutetskiy, Nikita S. Averkiev // *Solid State Commun.* — 2012. — Sept. — Vol. 152, no. 17. — Pp. 1690–1693.
172. Полевая зависимость скорости термической эмиссии дырок с комплекса $V_{\text{Ga}}S_{\text{As}}$ в арсениде галлия / Л.А. Кулакова, Н.С. Аверкиев, А.В. Лютецкий, В.А. Горелов // *Физика и техника полупроводников.* — 2013. — Т. 47, № 1. — С. 137–142.
173. *Kulakova, Liudmila A.* Acousto-optic interaction in nanodimensional laser heterostructures / Liudmila A. Kulakova // *Appl. Opt.* — 2009. — Feb. — Vol. 48, no. 6. — Pp. 1128–1134.

174. Л.А. Кулакова. Тонкая спектроскопия динамики излучения гетеролазеров в присутствии ультразвуковой деформации / Кулакова Л.А. // Физика гетеродомого тела. — 2009. — Т. 51, № 1. — С. 73–80.
175. Управление спектром излучения квантоворазмерных гетеролазеров с помощью ультразвуковой деформации / Л.А. Кулакова, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, И.С. Тараков // ЖЭТФ. — 2007. — Т. 131, № 5. — С. 790–797.
176. Кулакова, Л.А. Перестройка частоты генерации гетеролазера под влиянием ультразвуковых волн / Л.А. Кулакова, И.С. Тараков // Письма в ЖЭТФ. — 2003. — Т. 78, № 2. — С. 77–81.
177. Кулакова, Л.А. Градиентное управление направлением излучения InGaAsP/InP гетеролазеров / Л.А. Кулакова, А.В. Люгецкий, В.Б. Бояшинов // Письма в журнал технической физики. — 2010. — Т. 36, № 12. — С. 48–54.
178. Курилков, В.В. Управление процессами фотоэлектрического преобразования в гетероструктурах GaAs/AlGaAs с помощью пьезоэлектрических полей акустических колебаний / В.В. Курилков, О.А. Коротченков // Журнал технической физики. — 2009. — Т. 79, № 8. — С. 146–149.
179. Spatially modulated photoluminescence properties in dynamically strained GaAs/AlAs quantum wells by surface acoustic wave / Tetsuomi Sogawa, Haruki Sanada, Hideki Gotoh et al. // Appl. Phys. Lett. — 2012. — Apr. — Vol. 100, no. 16. — P. 162109.
180. Acoustically induced current in graphene by aluminum nitride transducers / Yan Chen, Hongxiang Zhang, Hao Zhang et al. // Appl. Phys. Lett. — 2016. — Jan. — Vol. 108, no. 3. — P. 033107.
181. Acoustic charge transport induced by the surface acoustic wave in chemical doped graphene / Shijun Zheng, Hao Zhang, Zhihong Feng et al. // Appl. Phys. Lett. — 2016. — Oct. — Vol. 109, no. 18. — P. 183110.

182. Poole, T. Acoustoelectric photoresponse in graphene / T. Poole, L. Bandhu, G. R. Nash // Appl. Phys. Lett. — 2015. — Mar. — Vol. 106, no. 13. — P. 133107.
183. Acoustically induced current flow in graphene / V. Miseikis, J. E. Cunningham, K. Saeed et al. // Appl. Phys. Lett. — 2012. — Mar. — Vol. 100, no. 13. — P. 133105.
184. On the acoustoelectric current in a one-dimensional channel / J. M. Shilton, D. R. Macé, V. I. Talyanskii et al. // J. Phys.: Condens. Matter. — 1996. — Jun. — Vol. 8, no. 24. — Pp. L337–L343.
185. Neto, A. Ranciaro. Electronic transport in disordered chains mediated by interactions with acoustic waves / A. Ranciaro Neto, M.O. Sales, F.A.B.F. de Moura // Solid State Commun. — 2016. — Mar. — Vol. 229. — Pp. 22–27.
186. Single-electron acoustic charge transport by two counterpropagating surface acoustic wave beams / J. Cunningham, V. I. Talyanskii, J. M. Shilton et al. // Phys. Rev. B. — 1999. — Aug. — Vol. 60. — Pp. 4850–4855.
187. The anomalous acoustoelectric current in single-electron transport devices with three pairs of shallow-etched gates / L.B. Liu, J. Gao, H.Z. Guo et al. // Physica B: Condensed Matter. — 2011. — Feb. — Vol. 406, no. 3. — Pp. 430–434.
188. On-demand single-electron transfer between distant quantum dots / R. P. G. McNeil, M. Kataoka, C. J. B. Ford et al. // Nature. — 2011. — Sep. — Vol. 477, no. 9. — Pp. 439–442.
189. Spin Pumping with Coherent Elastic Waves / M. Weiler, H. Huebl, F. S. Goerg et al. // Phys. Rev. Lett. — 2012. — Apr. — Vol. 108. — P. 176601.
190. Surface-acoustic-wave-driven ferromagnetic resonance in (Ga,Mn)(As,P) epilayers / L. Thevenard, C. Goudon, J. Y. Prieur et al. // Phys. Rev. B. — 2014. — Sep. — Vol. 90. — P. 094401.
191. Couto, Odilon D. D. Spin dynamics in (110) GaAs quantum wells under surface acoustic waves / Odilon D. D. Couto, R. Hey, P. V. Santos // Phys. Rev. B. — 2008. — Oct. — Vol. 78. — P. 155305.

192. Acoustically Induced Spin-Orbit Interactions Revealed by Two-Dimensional Imaging of Spin Transport in GaAs / H. Sanada, T. Sogawa, H. Gotoh et al. // *Phys. Rev. Lett.* — 2011. — May. — Vol. 106, no. 21. — P. 216602.
193. Magnetic recording with acoustic waves / Weiyang Li, Benjamin Buford, Albrecht Jander, Pallavi Dhagat // *Physica B: Condensed Matter.* — 2014. — Sep. — Vol. 448. — Pp. 151–154.
194. A sound idea: Manipulating domain walls in magnetic nanowires using surface acoustic waves / J. Dean, M. T. Bryan, J. D. Cooper et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2015. — Oct. — Vol. 107, no. 14. — P. 142405.
195. *Buscemi, Fabrizio.* Quantum teleportation of electrons in quantum wires with surface acoustic waves / Fabrizio Buscemi, Paolo Bordone, Andrea Bertoni // *Phys. Rev. B.* — 2010. — Jan. — Vol. 81. — P. 045312.
196. *Cuberes, M. T.* Atomic force microscopy manipulation with ultrasonic excitation / M. T. Cuberes // *Journal of Physics: Conference Series.* — 2008. — Vol. 100. — P. 052013.
197. Ultrasonic assisted nanomanipulations with atomic force microscope / P. M. Lytvyn, O. Ya. Olikh, O. S. Lytvyn et al. // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.* — 2010. — Vol. 13, no. 1. — Pp. 36–42.
198. *Andrade, Marco A. B.* Acoustic levitation of a large solid sphere / Marco A. B. Andrade, Anne L. Bernassau, Julio C. Adamowski // *Appl. Phys. Lett.* — 2016. — Jul. — Vol. 109, no. 4. — P. 044101.
199. Observation of Low-Temperature Elastic Softening due to Vacancy in Cystalline Silicon / Terutaka Goto, Hiroshi Yamada-Kanella, Yasuhiro Saito et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* — 2006. — Apr. — Vol. 75, no. 4. — P. 044602.
200. Strong Quadrupole-Strain Interaction of Vacancy Orbital in Boron-Doped Czochralski Silicon / Kazuki Okabe, Mitsuhiro Akatsu, Shotaro Baba et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* — 2013. — Dec. — Vol. 82, no. 12. — P. 124604.
201. Elastic Softening of Surface Acoustic Wave Caused by Vacancy Orbital in Silicon Wafer / Keisuke Mitsumoto, Mitsuhiro Akatsu, Shotaro Baba et al. // *J. Phys. Soc. Jpn.* — 2014. — Mar. — Vol. 83, no. 3. — P. 034702.
202. Ultrasonic study of vacancy in single crystal silicon at low temperatures / M. Akatsu, T. Goto, H. Y-Kaneta et al. // *Journal of Physics: Conference Series.* — 2009. — Vol. 150, no. 4. — P. 042002.
203. Ultrasonic exploration of vacancy centres with the Jahn-Teller effect. Application to the ZnSe crystal / N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *Phys. Status Solidi B.* — 2014. — Aug. — Vol. 251, no. 8. — Pp. 1590–1595.
204. Ultrasonic investigation of the Jahn-Teller effect in GaAs semiconductors doped by transition metals / N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *Appl. Phys.* — 2014. — Sep. — Vol. 116, no. 10. — P. 103708.
205. Effect of deep native defects on ultrasound propagation in TiInS_2 layered crystal / MirHasan Yu. Seyidov, Rauf A. Suleymanov, Andrei P. Odintsov, Cafer Karbaş // *Physica B: Condensed Matter.* — 2016. — Sep. — Vol. 497. — Pp. 86–92.
206. Numerical adiabatic potentials of orthorhombic Jahn-Teller effects retrieved from ultrasound attenuation experiments. Application to the $\text{SrF}_2\cdot\text{Cr}$ crystal / I. V. Chevostovskikh, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov et al. // *J. Appl. Phys.* — 2016. — Jun. — Vol. 119, no. 22. — P. 225108.
207. *Hui, Kong.* Ultrasonic study on the Jahn-Teller effect near different phase transitions in $\text{La}_{1/3}\text{Sr}_{2/3}\text{MO}_3$ ($\text{M}=\text{Mn, Fe, Co}$) / Kong Hui, Zhu Changfei // *Solid State Commun.* — 2012. — Sep. — Vol. 152, no. 18. — Pp. 1715–1718.
208. *Yi, Jianxing.* Ultrasonic study of the Jahn-Teller effect in $\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x\text{CoO}_3$ ($0.1 \leq x \leq 0.2$) / Jianxing Yi, Hui Kong, Changfei Zhu // *Journal of Alloys and Compounds.* — 2009. — Apr. — Vol. 474, no. 1–2. — Pp. 38–41.
209. *Belyaev, A.* Resonance ultrasonic diagnostics of defects in full-size silicon wafers / A. Belyaev, S. Ostapenko // *Physica B: Condensed Matter.* — 2001. —

- Dec. — Vol. 308–310. — Pp. 1137–1140. — International Conference on Defects in Semiconductors.
210. Non-contact defect diagnostics in Cz-Si wafers using resonance ultrasonic vibrations / A. Belyaev, V. A. Kochelap, I. Tarasov, S. Ostapenko // *AIP Conference Proceedings*. — 2001. — Vol. 550, no. 1. — Pp. 207–211.
211. Resonance ultrasonic vibrations in Cz-Si wafers as a possible diagnostic technique in ion implantation / Z. Y. Zhao, S. Ostapenko, R. Anundson et al. // *AIP Conference Proceedings*. — 2001. — Vol. 576, no. 1. — Pp. 1036–1039.
212. Dallas, W. Resonance ultrasonic vibrations for crack detection in photovoltaic silicon wafers / W. Dallas, O. Polupan, S. Ostapenko // *Meas. Sci. Technol.* — 2007. — Vol. 18, no. 3. — P. 852.
213. Ultrasonically stimulated temperature rise around dislocation: extended defect mapping and imaging / R. K. Savkina, A. B. Smirnov, V. V. Tetyorkin, N. M. Krolevc // *The European Physical Journal Applied Physics*. — 2004. — Jul. — Vol. 27, no. 1–3. — Pp. 375–377.
214. Savkina, R.K. Temperature rise in crystals subjected to ultrasonic influence / R.K. Savkina, A.B. Smirnov // *Infrared Physics & Technology*. — 2005. — Jun. — Vol. 46, no. 5. — Pp. 388–393.
215. Evaluation of radiation damage using nonlinear ultrasound / K. H. Matlack, J. J. Wall, J.-Y. Kim et al. // *J. Appl. Phys.* — 2012. — Mar. — Vol. 111, no. 5. — P. 054911.
216. A local defect resonance to enhance acoustic wave-defect interaction in ultrasonic nondestructive evaluation / Igor Soledov, Juxing Bai, Sumbat Bekgulyan, Gerd Busse // *Appl. Phys. Lett.* — 2011. — Nov. — Vol. 99, no. 21. — P. 211911.
217. Коротченков, О.А. Об идентификации точечных дефектов близи границы раздела полупроводников посредством возмущения акустической волной / О.А. Коротченков // *Физика и техника полупроводников*. — 1996. — Т. 30, № 7. — С. 1274–1278.

218. Ультразвуковое воздействие на спектры оптического пропускания и покачатель преломления в кристаллах CdS / О.А. Коротченков, А.Х. Рожко, А.М. Антонов, И.В. Острогский // *Физика твердого тела*. — 1993. — Т. 35, № 8. — С. 2244–2249.
219. Коротченков, О.А. Изучение эпитаксиальных структур GaAs методом акустомодуляции отражения света / О.А. Коротченков // *Физика и техника полупроводников*. — 1994. — Т. 28, № 7. — С. 1149–1154.
220. Characterization of semiconductor heterostructures by acousto-optical perturbation technique / I.V. Ostrovskii, O.A. Korotchenkov, R.M. Burbelo, H.G. Walther // *Materials Science and Engineering: B*. — 2000. — Jul. — Vol. 76, no. 2. — Pp. 139–144.
221. Fritz, I. J. Semiconductor characterization by a new contactless ellipsoreflectance technique employing surface acoustic waves / I. J. Fritz, T. M. Brennan // *Semicond. Sci. Technol.* — 1997. — Jan. — Vol. 12, no. 1. — P. 19.
222. Острогский, И.В. Спектроскопия поверхностных состояний в GaAs посредством акустоэлектрического эффекта / И.В. Острогский, С.В. Сайко // *Физика твердого тела*. — 1993. — Т. 44, № 4. — С. 1043–1050.
223. Ostrovskii, I. V. Determination of deep levels' parameters in epi-GaAs by a transient acoustoelectric technique / I. V. Ostrovskii, S. V. Saiko, H. G. Walther // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 1998. — Sep. — Vol. 31, no. 18. — Pp. 2319–2325.
224. Ostrovskii, I.V. Characterization of interface deep levels in As vapor grown EPI-GaAs / I.V. Ostrovskii, O.Ya. Olikh // *Solid State Commun.* — 1998. — Jul. — Vol. 107, no. 7. — Pp. 341–343.
225. Громашевский, В.И. Использование поларизованного акустоэлектрического эффекта для исследования заряжения поверхности кремния при адсорбции волны / В.Л. Громашевский, Н.П. Татьяненко, Б.А. Снопок // *Физика и техника полупроводников*. — 2013. — Т. 47, № 4. — С. 557–563.

226. Investigation of interface states distribution in metal–oxide–semiconductor structures with very thin oxides by acoustic spectroscopy / P. Bury, I. Bellan, H. Kobayashi et al. // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Oct. — Vol. 116, no. 14. — P. 144302.
227. Noncontact determination of thin films conductance by SH0 plate acoustic waves / I. E. Kuznetsova, B. D. Zaitsev, V. I. Anisimkin et al. // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Vol. 115, no. 4. — P. 044504.
228. Acoustic studies of ac conductivity mechanisms in n -GaAs/Al_xGa_{1-x}As in the integer and fractional quantum Hall effect regime / I. L. Drichko, I. Yu. Smirnov, A. V. Suslov, D. R. Leadley // *Phys. Rev. B*. — 2011. — Jun. — Vol. 83. — P. 235318.
229. Olikh, Ya.M. In Situ Observation of the Relaxation of Conductivity in γ -Irradiated n-Type Silicon under the Action of Ultrasound Pulses / Ya.M. Olikh, M.D. Tymochko // *Tech. Phys. Lett.* — 2011. — Jan. — Vol. 37, no. 1. — Pp. 37–40.
230. Breitenstein, O. Understanding the current-voltage characteristics of industrial crystalline silicon solar cells by considering inhomogeneous current distributions / O. Breitenstein // *Opto-Electronics Review*. — 2013. — Sep. — Vol. 21, no. 3. — Pp. 259–282.
231. Breitenstein, Ohwin. Non-Ideal I-V-Characteristics of Block-Cast Silicon Solar Cells / Ohwin Breitenstein, J. Heydenreich // *Solid State Phenomena*. — 1994. — Vol. 37–38. — Pp. 139–144.
232. Updated NIEL calculations for estimating the damage induced by particles and γ -rays in Si and GaAs / A. Akkerman, J. Barak, M.B. Chadwick et al. // *Radiat. Phys. Chem.* — 2001. — Oct. — Vol. 62, no. 4. — Pp. 301–310.
233. Nonionizing energy loss (NIEL) for heavy ions / S.R. Messenger, E.A. Burke, G.P. Summers et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 1999. — Dec. — Vol. 46, no. 6. — Pp. 1595–1602.
234. Gamma non-ionizing energy loss: Comparison with the damage factor in silicon devices / E. El Allam, C. Inguimbert, A. Meulenberg et al. // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Mar. — Vol. 123, no. 9. — P. 095703.
235. Bräunig, D. Atomic displacement and total ionizing dose damage in semiconductors / D. Bräunig, F. Wulf // *Radiat. Phys. Chem.* — 1994. — Jan–Feb. — Vol. 43, no. 1–2. — Pp. 105–107.
236. Huhtinen, M. Simulation of non-ionising energy loss and defect formation in silicon / M. Huhtinen // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2002. — Sep. — Vol. 491, no. 1–2. — Pp. 194–215.
237. Jafari, H. Analytical modeling for gamma radiation damage on silicon photodiodes / H. Jafari, S.A.H. Feghhi // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2016. — Apr. — Vol. 816. — Pp. 62–69.
238. 75 MeV boron ion irradiation studies on Si PIN photodiodes / Y.P. Prabhakara Rao, K.C. Praveen, Y. Rejeena Rani et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B*. — 2013. — Dec. — Vol. 316. — Pp. 205–209.
239. Comparison of defects produced by fast neutrons and ⁶⁰Co-gammars in high-resistivity silicon detectors using deep-level transient spectroscopy / M. Moll, H. Feick, E. Fretwurst et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 1997. — Apr. — Vol. 388, no. 3. — Pp. 335–339.
240. Srour, J.R. Review of displacement damage effects in silicon devices / J.R. Srour, C.J. Marshall, P.W. Marshall // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 2003. — Jun. — Vol. 50, no. 3. — Pp. 653–670.
241. A contribution to the identification of the E5 defect level as tri-vacancy (V3) / Alexandra Junkes, Ioana Pintilie, Eckhart Fretwurst, Doris Eckstein // *Physica B: Condensed Matter*. — 2012. — Aug. — Vol. 407, no. 15. — Pp. 3013–3015.
242. Positron probing of disordered regions in neutron-irradiated silicon / Nikolay Arutyunov, Nick Bennett, Neil Wight et al. // *Phys. Status Solidi B*. — 2016. — Nov. — Vol. 253, no. 11. — Pp. 2175–2179.

243. Londos, C. A. Di-interstitial defect in silicon revisited / C. A. Londos, G. Antonaras, A. Chroneos // *J. Appl. Phys.* — 2013. — Nov. — Vol. 114, no. 19. — P. 193513.
244. Таперо, К.И. Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах космического применения / К.И. Таперо, В.Н. Улимов, А.М. Членов. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. — 304 с.
245. Дьелисан, Э. Упругие волны в твёрдых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьелисан, Д. Руайе. — М.: Наука, 1982. — 424 с.
246. Акустические кристаллы / А.А. Блистанов, В.С. Бондаренко, Н.В. Переолова и др.; Под ред. М. П. Шлакольской. — М.: Наука, 1982. — 632 с.
247. Hu, Binxin. Reflection-type single long-pulse solar simulator for high-efficiency crystalline silicon photovoltaic modules / Binxin Hu, Buyin Li, Tiechen Zhao, Rixin Yang // *Rev. Sci. Instrum.* — 2011. — Jun. — Vol. 82, no. 6. — P. 065104.
248. Electronically stimulated degradation of silicon solar cells / J. Schmidt, K. Bothe, D. Macdonald et al. // *Journal of Materials Research*. — 2006. — Jan. — Vol. 21, no. 1. — Pp. 5–12.
249. Lindroos, Jeanette. Review of light-induced degradation in crystalline silicon solar cells / Jeanette Lindroos, Hele Savin // *Sol. Energy Mater: Sol. Cells*. — 2016. — Apr. — Vol. 147. — Pp. 115–126.
250. Degradation of Crystalline Silicon Due to Boron–Oxygen Defects / Tim Niewelt, Jonas Schön, Wilhelm Warta et al. // *IEEE Journal of Photovoltaics*. — 2017. — Jan. — Vol. 7, no. 1. — Pp. 383–398.
251. Modeling of light-induced degradation due to Cu precipitation in p-type silicon. II. Comparison of simulations and experiments / H. Vahlman, A. Haaralihutunen, W. Kwaplil et al. // *J. Appl. Phys.* — 2017. — May. — Vol. 121, no. 19. — P. 195704.
252. Recombination parameters of lifetime-limiting carrier-induced defects in multicrystalline silicon for solar cells / Carlos Vargas, Yan Zhu, Gianluca Coletti et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2017. — Feb. — Vol. 110, no. 9. — P. 092106.
253. Acceleration and mitigation of carrier-induced degradation in p-type multicrystalline silicon / D. N. R. Payne, C. E. Chan, B. J. Hallam et al. // *Phys. Status Solidi RRL*. — 2016. — Mar. — Vol. 10, no. 3. — Pp. 237–241.
254. Explanation of potential-induced degradation of the shunting type by Na decoration of stacking faults in Si solar cells / Volker Naumann, Dominik Lausch, Angelika Hahnel et al. // *Sol. Energy Mater: Sol. Cells*. — 2014. — Jan. — Vol. 120. — Pp. 383–389.
255. Hoffmann, Stephan. Effect of humidity and temperature on the potential-induced degradation / Stephan Hoffmann, Michael Koehl // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*. — 2012. — Feb. — Vol. 22, no. 2. — Pp. 173–179.
256. Influence of surface structure of n-type single-crystalline Si solar cells on potential-induced deInfluence / Kohjiro Hara, Kinichi Ogawa, Yusuke Okabayashi et al. // *Sol. Energy Mater: Sol. Cells*. — 2017. — Jul. — Vol. 166. — Pp. 132–139.
257. A study on the variation of c-Si solar cell parameters under 8 MeV electron irradiation / Sathyaranayana Bhat, Asha Rao, Sheeja Krishnan et al. // *Sol. Energy Mater: Sol. Cells*. — 2014. — Jan. — Vol. 120. — Pp. 191–196.
258. Karazhanov, S. Zh. Mechanism for the anomalous degradation of silicon space solar cells / S. Zh. Karazhanov // *Appl. Phys. Lett.* — 2000. — May. — Vol. 76, no. 19. — Pp. 2689–2691.
259. Acoustostimulated changes in the density of surface states and their energy spectrum in p-type silicon single crystals / N.N. Zaveryukhina, E.B. Zaveryukhina, S.I. Vlassov, B.N. Zaveryukhin // *Tech. Phys. Lett.* — 2008. — Mar. — Vol. 34, no. 3. — Pp. 241–243.
260. Ishaque, Kashif. Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules / Kashif Ishaque, Zainal Salam, Hamed Taheri // *Sol. Energy Mater: Sol. Cells*. — 2011. — Feb. — Vol. 95, no. 2. — Pp. 586–594.

261. Bühlér, Alexandre Jose. Method for photovoltaic parameter extraction according to a modified double-diode model / Alexandre Jose Bühlér, Arno Krenzinger // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2013. — Aug. — Vol. 21, no. 5. — Pp. 884–893.
262. Sproul, A. B. Intrinsic carrier concentration and minority-carrier mobility of silicon from 77 to 300 K / A. B. Sproul, M. A. Green // *J. Appl. Phys.* — 1993. — Feb. — Vol. 73, no. 3. — Pp. 1214–1225.
263. Green, Martin A. Intrinsic concentration, effective densities of states, and effective mass in silicon / Martin A. Green // *J. Appl. Phys.* — 1990. — Mar. — Vol. 67, no. 6. — Pp. 2944–2954.
264. Schröder, D. K. Semiconductor Material and Device Characterization / D. K. Schröder. — Third edition. — New Jersey: John Wiley & Sons, 2006. — 781 pp.
265. Solar Cells. Materials, Manufacture and Operation / Ed. by Augustin McEvoy, Tom Markvart, Luis Castaner. — Second edition. — Oxford: Academic Press, 2013. — 641 pp.
266. Sun, Jianyong. DE/EDA: A new evolutionary algorithm for global optimization / Jianyong Sun, Qingfu Zhang, Edward PK. Tsang // *Inform. Sci.* — 2005. — Feb. — Vol. 169, no. 3–4. — Pp. 249–262.
267. Wang, Kaier. Parameter determination of Schottky-barrier diode model using differential evolution / Kaier Wang, Meiyang Ye // *Solid-State Electron.* — 2009. — Feb. — Vol. 53, no. 2. — Pp. 234–240.
268. Adaptive differential evolution algorithm with novel mutation strategies in multiple sub-populations / Laizhong Cui, Genghui Li, Qiujuhen Lin et al. // *Computers & Operations Research.* — 2016. — Mar. — Vol. 67. — Pp. 155–173.
269. Series resistance characterization of industrial silicon solar cells with screen-printed contacts using hotmelt paste / A. Mette, D. Pysch, G. Emanuel et al. // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2007. — Sep. — Vol. 15, no. 6. — Pp. 493–505.

270. Modeling of light-induced degradation due to Cu precipitation in p-type silicon. II. Comparison of simulations and experiments / H. Vahlman, A. Haaralahti, W. Kwapił et al. // *J. Appl. Phys.* — 2017. — May. — Vol. 121, no. 19. — P. 195704.
271. Implications of Accelerated Recombination–Active Defect Complex Formation for Mitigating Carrier-Induced Degradation in Silicon / Brett J. Hallam, Malcolm D. Abbott, Nitin Nampalli et al. // *IEEE Journal of Photovoltaics.* — 2016. — Jan. — Vol. 6, no. 1. — Pp. 92–99.
272. Razeghi, M. Semiconductor ultraviolet detectors / M. Razeghi, A. Rogalski // *J. Appl. Phys.* — 1996. — May. — Vol. 79, no. 10. — Pp. 7433–7473.
273. Фаренбрук, А. Солнечные элементы. Теория и эксперимент / А. Фаренбрук, Р. Бьюб. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 280 с.
274. Гаман, В.И. Физика полупроводниковых приборов / В.И. Гаман. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. — 336 с.
275. Rajkumar, K. Absorption coefficient of silicon for solar cell calculations / K. Rajkumar, R. Singh, J. Shewchun // *Solid-State Electron.* — 1979. — Sep. — Vol. 22, no. 9. — Pp. 793–795.
276. Khan, Firoz. Effect of illumination intensity on cell parameters of a silicon solar cell / Firoz Khan, S.N. Singh, M. Husain // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2010. — Sep. — Vol. 94, no. 9. — Pp. 1473–1476.
277. Investigation of unusual shunting behavior due to phototransistor effect in n-type aluminum-alloyed rear junction solar cells / Adeline Sugianto, Budi S. Tjahjono, Ly Mai, Stuart R. Wenham // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2009. — Nov. — Vol. 93, no. 11. — Pp. 1986 – 1993.
278. Robinson, S. J. Departures from the principle of superposition in silicon solar cells / S. J. Robinson, A. G. Aberle, M. A. Green // *J. Appl. Phys.* — 1994. — Dec. — Vol. 76, no. 12. — Pp. 7920–7930.

279. Breitenstein, O. A two-diode model regarding the distributed series resistance / O. Breitenstein, S. Rijland // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2013. — Mat. — Vol. 110. — Pp. 77–86.
280. Effect of oxygen precipitation on the performance of Czochralski silicon solar cells / Lin Chen, Xuegong Yu, Peng Chen et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2011. — Nov. — Vol. 95, no. 11. — Pp. 3148–3151.
281. Identification of lifetime limiting defects by temperature- and injection-dependent photoluminescence imaging / Jonas Schön, Amanda Youssef, Sungeun Park et al. // *J. Appl. Phys.* — 2016. — Sep. — Vol. 120, no. 10. — P. 105703.
282. Evaluating Crystalline Silicon Solar Cells at Low Light Intensities Using Intensity-Dependent Analysis of I-V Parameters / Karola Rühle, Matthias K. Juhl, Malcolm D. Abbott, Martin Kasemann // *IEEE Journal of Photovoltaics.* — 2015. — May. — Vol. 5, no. 3. — Pp. 926–931.
283. Crystalline silicon cell performance at low light intensities / N.H. Reich, W.G.J.H.M. van Sark, E.A. Alsema et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2009. — Sep. — Vol. 93, no. 9. — Pp. 1471–1481.
284. The Influence of Parasitic Effects on Injection-Level-Dependent Lifetime Data / Florence W. Chen, Jeffrey E. Cottler, Malcolm D. Abbott et al. // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 2007. — Nov. — Vol. 54, no. 11. — Pp. 2960–2968.
285. Macdonald, Daniel. Reduced fill factors in multicrystalline silicon solar cells due to injection-level dependent bulk recombination lifetimes / Daniel Macdonald, Andres Cuevas // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2000. — Jul. — Vol. 8, no. 4. — Pp. 363–375.
286. Recombination rate saturation mechanisms at oxidized surfaces of high-efficiency silicon solar cells / S. J. Robinson, S. R. Wenham, P. P. Alternatt et al. // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Oct. — Vol. 78, no. 7. — Pp. 4740–4754.
287. Bandlike and localized states at extended defects in silicon / W. Schröter, J. Krohnwitz, U. Gnauert et al. // *Phys. Rev. B.* — 1995. — Nov. — Vol. 52. — Pp. 13726–13729.

288. Особливості формування рекомбінаційного струму в області просторово-го заряду кремнієвих сонячних елементів / А.В. Саценко, В.П. Косятков, В.М. Влащок та ін. // УФЖ. — 2016. — Т. 61, № 10. — С. 923–928751.
289. Schroder, D.K. The concept of generation and recombination lifetimes in semiconductors / D.K. Schroder // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 1982. — Aug. — Vol. 29, no. 8. — Pp. 1336–1338.
290. Analysis of n^+p silicon junctions with varying substrate doping concentrations made under ultraclean processing technology / Herzl Aharoni, Tadahiro Ohmi, Mauricio Massazumi Oka et al. // *J. Appl. Phys.* — 1997. — Feb. — Vol. 81, no. 3. — Pp. 1270–1288.
291. Explanation of High Solar Cell Diode Factors by Nonuniform Contact Resistance / A. S. H. van der Heide, A. Schonecker, J. H. Bultman, W. C. Sinke // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2005. — Jan. — Vol. 13, no. 1. — Pp. 3–16.
292. Beier, Jutta. Humps in dark I-V-curves — Analysis and explanation / Jutta Beier, Bernhard Voss // Proceedings of the 23rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference. — 1993. — May. — Pp. 321–326. — Louisville, KY, USA.
293. Experimental analysis and theoretical model for anomalously high ideality factors ($n \gg 2.0$) in AlGaN/GaN p-n junction diodes / Jay M. Shah, Y.-L. Li, Th. Gessmann, E. F. Schubert // *J. Appl. Phys.* — 2003. — Aug. — Vol. 94, no. 4. — Pp. 2627–2630.
294. Conduction processes in silicon solar cells / A. Kaminski, J. J. Marchand, H. E. Omari et al. // Proceedings of the 25th IEEE Photovoltaic Specialists Conference. — 1996. — May. — Pp. 573–576. — Washington, DC, USA.
295. Direct observation of intercenter charge transfer in dominant nonradiative recombination channels in silicon / W. M. Chen, B. Monemar, E. Janzen, J. L. Lindström // *Phys. Rev. Lett.* — 1991. — Sep. — Vol. 67, no. 14. — Pp. 1914–1917.

296. Observation of rapid direct charge transfer between deep defects in silicon / A. M. Frens, M. T. Bennebroek, A. Zakizewski et al. // *Phys. Rev. Lett.* — 1994. — May. — Vol. 72, no. 18. — Pp. 2939–2942.
297. Schenka, Andreas. Coupled defect-level recombination: Theory and application to anomalous diode characteristics / Andreas Schenka, Ulrich Krumbein // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Sep. — Vol. 78, no. 5. — Pp. 3185–3192.
298. Explanation of commonly observed shunt currents in c-Si solar cells by means of recombination statistics beyond the Shockley-Read-Hall approximation / Silke Steingrube, Otwin Breitenstein, Klaus Ramspeck et al. // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Vol. 110, no. 1. — P. 014515.
299. Influence of Defects on Solar Cell Characteristics / Otwin Breitenstein, Jan Bauer, Pietro P. Altermatt, Klaus Ramspeck // *Solid State Phenomena*. — 2010. — Vol. 156–158. — Pp. 1–10.
300. Defect induced non-ideal dark I–V characteristics of solar cells / O. Breitenstein, J. Bauer, A. Lotnyk, J.-M. Wagner // *Superlattices Microstruct.* — 2009. — Apr. — Vol. 45, no. 4–5. — Pp. 182 – 189.
301. Non-Radiative Carrier Recombination Enhanced by Two-Level Process: A First-Principles Study / Ji-Hui Yang, Lin Shi, Lin-Wang Wang, Su-Huai Wei // *Scientific Reports*. — 2016. — Vol. 6. — P. 21712.
302. Sze, S. M. Semiconductor Devices: Physics and Technology / S. M. Sze, M.K. Lee. — Second edition. — New York: John Wiley & Sons, Inc, 2012. — 578 pp.
303. The effect of oxide precipitates on minority carrier lifetime in p-type silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, M. Olmo et al. // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Sep. — Vol. 110, no. 5. — P. 053713.
304. Schlangenotto, H. Temperature dependence of the radiative recombination coefficient in silicon / H. Schlangenotto, H. Maeder, W. Gerlach // *Phys. Status Solidi A*. — 1974. — Jan. — Vol. 21, no. 1. — Pp. 357–367.
305. Kerr, Mark J. General parameterization of Auger recombination in crystalline silicon / Mark J. Kerr, Andres Cuevas // *J. Appl. Phys.* — 2002. — Feb. — Vol. 91, no. 4. — Pp. 2473–2480.
306. Pavlovich, V. N. Enhanced Diffusion of Impurities and Defects in Crystals in Conditions of Ultrasonic and Radiative Excitation of the Crystal Lattice / V. N. Pavlovich // *Phys. Status Solidi B*. — 1993. — Nov. — Vol. 180, no. 1. — Pp. 97–105.
307. Mirzade, F.X. Нелинейные продольные волны взаимодействующих полей деформации и концентрации дефектов в германии и кремнии / Ф.Х. Мирзаде // *Физика и техника полупроводников*. — 2006. — Т. 40, № 3. — С. 269–275.
308. Mirzade, Fikret. Elastic wave propagation in a solid layer with laser-induced point defects / Fikret Mirzade // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Sep. — Vol. 110, no. 6. — P. 064906.
309. Пеленак, Р.М. Формування періодичних структур під впливом акустичної хвилі у напівпровідниках з двокомпонентного дефектного підсистемою / Р.М. Пеленак, О.В. Кузик, О.О. Даньків // УФЖ. — 2016. — Т. 61, № 8. — С. 746–751.
310. Krevchik, V. D. Influence of ultrasound on ionic diffusion process in semiconductors / V. D. Krevchik, R. A. Mumino, A. Ya. Yafasov // *Phys. Status Solidi A*. — 1981. — Feb. — Vol. 63, no. 2. — Pp. K159–K162.
311. Mirzade, F.Kh. Nonlinear longitudinal strain wave interacting with point defect in metal plates / F.Kh. Mirzade // *J. Appl. Phys.* — 2005. — Apr. — Vol. 97, no. 8. — P. 084911.
312. Ostrovskii, I.V. Characterization of unstable point defects in crystals / I.V. Ostrovskii, O.A. Korochenkov // *Solid State Commun.* — 1992. — Apr. — Vol. 82, no. 4. — Pp. 267–270.
313. Thurston, R. N. Interpretation of Ultrasonic Experiments on Finite-Amplitude Waves / R. N. Thurston, M. J. Shapiro // *The Journal of the Acoustical Society of America*. — 1967. — Mar. — Vol. 41, no. 4B. — Pp. 1112–1125.

314. Cantrell, John H. Acoustic-radiation stress in solids. I. Theory / John H. Cantrell // *Phys. Rev. B.* — 1984. — Sep. — Vol. 30. — Pp. 3214–3220.
315. Yost, W. T. Acoustic-radiation stress in solids. II. Experiment / W. T. Yost, John H. Cantrell // *Phys. Rev. B.* — 1984. — Sep. — Vol. 30. — Pp. 3221–3227.
316. Philip, Jacob. Temperature variation of some combinations of third-order elastic constants of silicon between 300 and 3 °K / Jacob Philip, M. A. Brazeale // *J. Appl. Phys.* — 1981. — May. — Vol. 52, no. 5. — Pp. 3383–3387.
317. Thomas, D. G. Kinetics of Radiative Recombination at Randomly Distributed Donors and Acceptors / D. G. Thomas, J.J. Hopfield, W. M. Augisztyniak // *Phys. Rev.* — 1965. — Oct. — Vol. 140, no. 1A. — Pp. A202–A220.
318. Impact of phosphorus gettering parameters and initial iron level on silicon solar cell properties / Ville Vahanissi, Antti Haarahiltunen, Heli Talvitie et al. // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2013. — Aug. — Vol. 21, no. 5. — Pp. 1127–1135.
319. Schmidt, Jan. Effect of Dissociation of Iron-Boron Pairs in Crystalline Silicon on Solar Cell Properties / Jan Schmidt // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2005. — Jun. — Vol. 13, no. 4. — Pp. 325–331.
320. Mcchedlidze, Teimuraz. Iron-related carrier traps near the n⁺p-junctions of crystalline silicon solar cells; impacts of feedstock and of the fabrication processes / Teimuraz Mcchedlidze, Jorg Weber // *Phys. Status Solidi B.* — 2014. — Aug. — Vol. 251, no. 8. — Pp. 1608–1613.
321. Local detection of deep carrier traps in the pn-junction of silicon solar cells / T. Mcchedlidze, L. Scheffler, J. Weber et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2013. — Jul. — Vol. 103, no. 01. — P. 013901.
322. Minority carrier lifetime in silicon photovoltaics: The effect of oxygen precipitation / J.D. Murphy, J.D. McGuire, K. Bothe et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells.* — 2014. — Jan. — Vol. 120. — Pp. 402–411.
323. Parametrisation of injection-dependent lifetime measurements in semiconductors in terms of Shockley–Read–Hall statistics: An application to oxide precipitates in silicon / J. D. Murphy, K. Bothe, R. Krain et al. // *J. Appl. Phys.* — 2012. — Jun. — Vol. 111, no. 11. — P. 113709.
324. Porriini, M. Minority carrier lifetime of p-type silicon containing oxygen precipitates: influence of injection level and precipitate size/density / M. Porriini, P. Tessariol // *Materials Science and Engineering: B.* — 2000. — Apr. — Vol. 73, no. 1–3. — Pp. 244–249.
325. Modulating the extent of fast and slow boron-oxygen related degradation in Czochralski silicon by thermal annealing: Evidence of a single defect / Moonyong Kim, Malcolm Abbott, Nitin Nampalli et al. // *J. Appl. Phys.* — 2017. — Feb. — Vol. 121, no. 5. — P. 053106.
326. Wijaranakula, W. The Reaction Kinetics of Iron-Boron Pair Formation and Dissociation in P-Type Silicon / W. Wijaranakula // *J. Electrochem. Soc.* — 1993. — Jan. — Vol. 140, no. 1. — Pp. 275–281.
327. Hwang, J. M. Recombination properties of oxygen-precipitated silicon / J. M. Hwang, D. K. Schroder // *J. Appl. Phys.* — 1986. — Apr. — Vol. 59, no. 7. — Pp. 2476–2487.
328. Impact of oxygen related extended defects on silicon diode characteristics / J. Vanhellemont, E. Simoen, A. Kaniava et al. // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Jun. — Vol. 77, no. 11. — Pp. 5669–5676.
329. Oxygen defect processes in silicon and silicon germanium / A. Chronacos, E. N. Sgourou, C. A. Londos, U. Schwingenschlögl // *Applied Physics Reviews.* — 2015. — Jun. — Vol. 2, no. 2. — P. 021306.
330. Impurity engineering of Czochralski silicon / Xuegong Yu, Jiahe Chen, Xiangyang Ma, Deren Yang // *Materials Science and Engineering: R: Reports.* — 2013. — Jan–Feb. — Vol. 74, no. 1–2. — Pp. 1–33.

331. Effect of oxide precipitates on minority–carrier lifetime in Czochralski-grown silicon / Masami Miyagi, Kazumi Wada, Jiro Osaka, Naohisa Inoue // *J. Appl. Phys.* — 1982. — Vol. 40, no. 8. — Pp. 719–721.
332. Impact of interstitial iron on the study of meta-stable B–O defects in Czochralski silicon: Further evidence of a single defect / Moonyong Kim, Daniel Chen, Malcolm Abbott et al. // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Vol. 123, no. 16. — P. 161586.
333. Смирнов, Л.С. Атомные процессы в полупроводниковых кристаллах / Л.С. Смирнов // *Физика и техника полупроводников*. — 2001. — Т. 35, № 9. — С. 1029–1031.
334. Козловский, В.В. Модифицирование полупроводников пучками протонов / В.В. Козловский, В.А. Козлов, В.Н. Ломасов // *Физика и техника полупроводников*. — 2000. — Т. 34, № 2. — С. 129–147.
335. Челядинский, А.Р. Дефектно-примесная инженерия в имплантированном кремнии / А.Р. Челядинский, Ф.Ф. Комаров // *Успехи физических наук*. — 2003. — Т. 173, № 8. — С. 813–846.
336. Определение параметров глубоких уровней по дифференциальному коэффициентамвольт–амперных характеристик / С.В. Булярский, М.О. Борбьев, Н.С. Грушко, А.В. Лакалин // *Лисьина в журнале технической физики*. — 1999. — Т. 25, № 5. — С. 22–27.
337. Лугаков, И.Ф. Влияние примесного состава на образование центров рекомбинации при облучении n-кремния γ-квантами высоких энергий / И.Ф. Лугаков, В.Д. Гачев, Шуша В.В. // *Физика и техника полупроводников*. — 1979. — Т. 13, № 5. — С. 875–880.
338. Electronic properties of dislocations introduced mechanically at room temperature on a single crystal silicon surface / Masatoshi Ogawa, Shoji Kamiya, Hayato Izumi, Yutaka Tokuda // *Physica B: Condensed Matter*. — 2012. — Aug. — Vol. 407, no. 15. — Pp. 3034–3037.
339. Electrical properties of dislocations and point defects in plastically deformed silicon / P. Omling, E. R. Weber, L. Montelius et al. // *Phys. Rev. B*. — 1985. — Nov. — Vol. 32, no. 10. — Pp. 6571–6581.
340. Kittler, Martin. Influence of contamination on the electrical activity of crystal defects in silicon / Martin Kittler, Winfried Seifert, Klaus Knobloch // *Microelectron. Eng.* — 2003. — Apr. — Vol. 66, no. 1–4. — Pp. 281–288.
341. Electronic and dynamical properties of the silicon trivacancy / J. Coutinho, V. P. Markovich, A. R. Peaker et al. // *Phys. Rev. B*. — 2012. — Nov. — Vol. 86. — P. 174101.
342. Trivacancy and trivacancy–oxygen complexes in silicon: Experiments and *ab initio* modeling / V. P. Markovich, A. R. Peaker, S. B. Lastovskii et al. // *Phys. Rev. B*. — 2009. — Dec. — Vol. 80, no. 23. — P. 235207.
343. Transformation of divacancies to divacancy–oxygen pairs in p-type Czochralski-silicon; mechanism of divacancy diffusion / N. Ganagona, L. Vines, E. V. Monakhov, B. G. Svensson // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Jan. — Vol. 115, no. 3. — P. 034514.
344. Лукьянича, В.В. Уровни вакансий и междузельных атомов в запрещенной зоне кремния / В.В. Лукьянича // *Физика и техника полупроводников*. — 2003. — Т. 37, № 4. — С. 422–431.
345. Kuchinskii, P.V. The effect of thermal and radiation defects on the recombination properties of the region of diffused silicon p-n structures / P.V. Kuchinskii, V.M. Lomako // *Solid-State Electron.* — 1986. — Oct. — Vol. 29, no. 10. — Pp. 1041–1051.
346. Karazhanov, S. Zh. Methods for determining deep defect concentration from dependence of excess carrier density and lifetime on illumination intensity / S. Zh. Karazhanov // *Semicond. Sci. Technol.* — 2001. — Apr. — Vol. 16, no. 4. — Pp. 276–280.

347. The vacancy-donor pair in unstrained silicon, germanium and SiGe alloys / A. R. Peaker, V. P. Markevich, F.D. Auret et al. // *J. Phys.: Condens. Matter.* — 2005. — Jun. — Vol. 17, no. 22. — Pp. S2293–S2302.
348. Ion mass effect on vacancy-related deep levels in Si induced by ion implantation / E. V. Monakhov, J. Wong-Leung, A. Yu. Kuznetsov et al. // *Phys. Rev. B*. — 2002. — May. — Vol. 65, no. 24. — P. 245201.
349. Nakashima, H. Electrical and thermal properties of structurally metastable iron-boron pairs in silicon / H. Nakashima, T. Sadoh, T. Tsurushima // *Phys. Rev. B*. — 1994. — Jun. — Vol. 49, no. 24. — Pp. 16983–16993.
350. Istratov, A. A. Iron and its complexes in silicon / A. A. Istratov, H. Hieslmair, E.R. Weber // *Applied Physics A: Materials Science & Processing*. — 1999. — Jul. — Vol. 69, no. 1. — Pp. 13–44.
351. Перебудова дефектної структури та центрів дислокаційної пломіністенії у притоверхневих шарах *p*-Si / Б. В. Павлик, М. О. Кушник, Д. П. Слободзян, Р. М. Лис // *Журнал фізичних досліджень*. — 2017. — Т. 21, № 1–2. — С. 1601–1–1601–8.
352. The self-interstitial in silicon and germanium / R. Jones, A. Carvalho, J.P. Goss, P.R. Briddon // *Materials Science and Engineering: B*. — 2009. — Mar. — Vol. 159–160. — Pp. 112–116.
353. Rein, S. Electronic properties of the metastable defect in boron-doped Czochralski silicon: Unambiguous determination by advanced lifetime spectroscopy / S. Rein, S. W. Glunz // *Appl. Phys. Lett.* — 2003. — Feb. — Vol. 82, no. 7. — Pp. 1054–1056.
354. Mchedlidze, Teimouraz. Electrical Activity of Defects Induced by Oxygen Precipitation in Czochralski-Grown Silicon Wafers / Teimouraz Mchedlidze, Kei Matsumoto, Eiichi Asano // *Japanese Journal of Applied Physics*. — 1999. — Jun. — Vol. 38, no. 6A. — Pp. 3422–3425.
355. Deep levels associated with oxygen precipitation in CZ silicon and correlation with minority carrier lifetimes / S. S. Chan, C. J. Barker, J. D. Whitfield, R. Peaker, B. Hamilton et al. // *Physica B: Condensed Matter*. — 2012. — Aug. — Vol. 407, no. 15. — Pp. 2974–2977.

- R. W. Carpenter // *Materials Research Society Symposium Proceedings* / Ed. by N. M. Johnson, S. G. Bishop, G. D. Watkins. — Vol. 46. — North-Holland, NY: 1985. — Pp. 281–286.
356. Seebauer, Edmund G. Charged point defects in semiconductors / Edmund G. Seebauer, Meredith C. Kratzer // *Materials Science and Engineering: Reports*. — 2006. — Dec. — Vol. 55, no. 3–6. — Pp. 57 – 149.
357. Recent insights into boron-oxygen related degradation: Evidence of a single defect / Brett Hallam, Moonyong Kim, Malcolm Abbott et al. // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*. — 2017. — Dec. — Vol. 173. — Pp. 25 – 32.
358. Cavalcoli, D. Defect states in plastically deformed *n*-type silicon / D. Cavalcoli, A. Cavallini, E. Gombia // *Phys. Rev. B*. — 1997. — Oct. — Vol. 56, no. 15. — Pp. 10208–10214.
359. Kveder, Vitaly V. Dislocations in Silicon and D-Band Luminescence for Infrared Light Emitters / Vitaly V. Kveder, Martin Kittler // *Materials Science Forum*. — 2008. — Vol. 590. — Pp. 29–56.
360. Electrical levels of dislocation networks in p- and n-type Si / I. Isakova, A. Bondarenko, O. Vyvenko et al. // *Journal of Physics: Conference Series*. — 2011. — Vol. 281, no. 1. — P. 012010.
361. Челядинский, А.Р. Модель пары: атом фосфора–междоузельный атом кремния / А.Р. Челядинский, В.А. Буренков // *Физика твердого тела*. — 1998. — Т. 40, № 11. — С. 1995–1998.
362. Electrical activity of multivacancy defects in silicon / P. Santos, J. Coutinho, M. J. Rayson, P. R. Briddon // *Phys. Status Solidi C*. — 2012. — Oct. — Vol. 9, no. 10–11. — Pp. 2000–2004.
363. Reconfigurations and diffusion of trivacancy in silicon / V. P. Markevich, A. R. Peaker, B. Hamilton et al. // *Physica B: Condensed Matter*. — 2012. — Aug. — Vol. 407, no. 15. — Pp. 2974–2977.

364. Harris, R. D. Negative-U defect: Interstitial boron in silicon / R. D. Harris, J. L. Newton, G. D. Watkins // *Phys. Rev. B*. — 1987. — Jul. — Vol. 36, no. 2. — Pp. 1094–1104.
365. Hu, S.M. Nonequilibrium point defects and diffusion in silicon / S.M. Hu // *Materials Science and Engineering: R: Reports*. — 1994. — Oct. — Vol. 13, no. 3. — Pp. 105 – 192.
366. Fast and slow lifetime degradation in boron-doped Czochralski silicon described by a single defect / Brett Hallam, Malcolm Abbott, Tine Nærland, Stuart Wenzham // *Phys. Status Solidi RRL*. — 2016. — Jul. — Vol. 10, no. 7. — Pp. 520–524.
367. Defect engineering of Czochralski single-crystal silicon / T. Sinno, E. Dornberger, W. von Ammon et al. // *Materials Science and Engineering: R: Reports*. — 2000. — Jul. — Vol. 28, no. 5–6. — Pp. 149–198.
368. Defects involving interstitial boron in low-temperature irradiated silicon / I. I. Khirunenko, M. G. Sosnin, A. V. Duvanskii et al. // *Phys. Rev. B*. — 2016. — Dec. — Vol. 94, no. 23. — P. 235210.
369. Voronkov, V. The nature of boron-oxygen lifetime-degrading centres in silicon / V. Voronkov, R. Falster // *Phys. Status Solidi C*. — 2016. — Dec. — Vol. 13, no. 10–12. — Pp. 712–717.
370. Kvæder, V. Recombination activity of contaminated dislocations in silicon: A model describing electron-beam-induced current contrast behavior / V. Kvæder, M. Kittler, W. Schröter // *Phys. Rev. B*. — 2001. — Mar. — Vol. 63, no. 11. — P. 115208.
371. Radiation hard silicon detectors — developments by the RD48 (ROSE) collaboration / G. Lindström, M. Ahmed, S. Albergo et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2001. — Jul. — Vol. 406, no. 2. — Pp. 308–326.
372. Radiation-induced point- and cluster-related defects with strong impact on damage properties of silicon detectors / Ioana Pintilie, Gunnar Lindstrom, Alexandra Junkes, Eckhart Fretwurst // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2009. — Nov. — Vol. 611, no. 1. — Pp. 52–68.
373. Moll, Michael. Radiation damage in silicon particle detectors: Microscopic defects and macroscopic properties: Ph.D. thesis / Universität Hamburg. — 1999. — 259 pp.
374. Deep defect levels in standard and oxygen enriched silicon detectors before and after $^{60}\text{Co}-\gamma$ -irradiation / J. Stahl, E. Fretwurst, G. Lindström, I. Pintilie // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2003. — Oct. — Vol. 512, no. 1–2. — Pp. 111–116.
375. Колковский, И.И. Особенности накопления радиационных дефектов вакансационного и междуузельного типов в бездислокационном кремни с различным содержанием кислорода / И.И. Колковский, В.В. Лукьянца // *Физика и техника полупроводников*. — 1997. — Т. 31, № 4. — С. 405–409.
376. Siemieniec, R. Applying device simulation for lifetime-controlled devices / R. Siemieniec, W. Sudkamp, J. Lutz // Proceedings of the Fourth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. — Oranjestad, Aruba, Netherlands: 2002. — Apr. — Pp. D029–1–D029–6.
377. Radiation damage studies on MCz and standard and oxygen enriched epitaxial silicon devices / E. Fretwurst, F. Hönniger, G. Kramberger et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2007. — Dec. — Vol. 583, no. 1. — Pp. 58–63.
378. Interstitial Defect Reactions in Silicon / Lionel C. Kimerling, M.T. Asom, J.L. Benton et al. // Defects in Semiconductors 15 / Ed. by G. Ferenczi. — Vol. 38 of *Materials Science Forum*. — Trans Tech Publications, 1991. — 1. — Pp. 141–150.
379. Bistable interstitial-carbon—substitutional-carbon pair in silicon / L. W. Song, X. D. Zhan, B. W. Benson, G. D. Watkins // *Phys. Rev. B*. — 1990. — Sep. — Vol. 42, no. 9. — Pp. 5765–5783.
380. Бистабильность и электрическая активность комплекса вакансия–два атома кислорода в кремнии / Л.И. Мурин, В.П. Маркевич, И.Ф. Медведева, Л. Dobaczewski // *Физика и техника полупроводников*. — 2006. — Т. 40, № 11. — С. 1316–1320.

381. *Gaubas, E.* Spectroscopy of neutron irradiation induced deep levels in silicon by microwave probed photoconductivity transients / E. Gaubas, A. Uleckas, J. Vaitkus // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* — 2009. — Aug. — Vol. 607, no. 1. — Pp. 92–94.
382. *Kolkovskii, I. I.* Charge-carrier recombination in silicon irradiated with γ -rays of different energies / I. I. Kolkovskii, P. F. Lugakov, V. V. Shusha // *Phys. Status Solidi A.* — 1984. — May. — Vol. 83, no. 1. — Pp. 299–306.
383. Evolution from point to extended defects in ion implanted silicon / J. L. Benton, S. Libertino, P. Kringskjøl et al. // *J. Appl. Phys.* — 1997. — Jul. — Vol. 82, no. 1. — Pp. 120–125.
384. Depth profiles of vacancy- and interstitial-type defects in MeV implanted Si / S. Coffa, V. Privitera, F. Priolo et al. // *J. Appl. Phys.* — 1997. — Feb. — Vol. 81, no. 4. — Pp. 1639–1644.
385. Defects in p-type Cz-silicon irradiated at elevated temperatures / Naveen-goud Ganagona, Bahman Raeissi, Lasse Vines et al. // *Phys. Status Solidi C.* — 2012. — Oct. — Vol. 9, no. 10–11. — Pp. 2009–2012.
386. Formation and origin of the dominating electron trap in irradiated p-type silicon / Lasse Vines, E. V. Monakhov, A. Yu. Kuznetsov et al. // *Phys. Rev. B.* — 2008. — Aug. — Vol. 78, no. 8. — P. 085205.
387. *Brotherton, S. D.* Defect production and lifetime control in electron and γ -irradiated silicon / S. D. Brotherton, P. Bradley // *J. Appl. Phys.* — 1982. — Aug. — Vol. 53, no. 8. — Pp. 5720–5732.
388. Shunt Types in Crystalline Silicon Solar Cells / O. Breitenstein, J. P. Rakotomaina, M. H. Al Rifai, M. Werner // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications.* — 2004. — Nov. — Vol. 12, no. 7. — Pp. 529–538.
389. *Breitenstein, O.* Material-induced shunts in multicrystalline silicon solar cells / O. Breitenstein, J. Bauer, Rakotomaina J.P. // *Физика и механика полупроводников.* — 2007. — Vol. 41, no. 4. — Pp. 454–457.

390. *Gopal, Vishnu.* A new approach to investigate leakage current mechanisms in infrared photodiodes from illuminated current-voltage characteristics / Vishnu Gopal // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Aug. — Vol. 116, no. 8. — P. 084502.
391. *Baker, I.M.* Summary of HgCdTe 2D Array Technology in the U.K. / I.M. Baker, C.D. Maxey // *J. Electron. Mater.* — 2001. — Jun. — Vol. 30, no. 6. — Pp. 682–689.
392. On the electronic properties of a single dislocation / Manfred Reiche, Martin Kittler, Wilfried Erfurth et al. // *J. Appl. Phys.* — 2014. — May. — Vol. 115, no. 19. — P. 194303.
393. *Gopal, Vishnu.* Effect of Dislocations on the Zero-Bias Resistance-Area Product, Quantum Efficiency, and Spectral Response of LWIR HgCdTe Photovoltaic Detectors / Vishnu Gopal, Sudha Gupta // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 2003. — May. — Vol. 50, no. 5. — Pp. 1220–1226.
394. *Gopal, Vishnu.* Contribution of Dislocations to the Zero-Bias Resistance-Area Product of LWIR HgCdTe Photodiodes at Low Temperatures / Vishnu Gopal, Sudha Gupta // *IEEE Trans. Electron Devices.* — 2004. — Jul. — Vol. 51, no. 7. — Pp. 1078–1083.
395. Experimental Evidence of Dislocation Related Shallow States in p-Type Si / A. Castaldini, D. Cavalcoli, A. Cavallini, S. Pizzini // *Phys. Rev. Lett.* — 2005. — Aug. — Vol. 95, no. 7. — P. 076401.
396. Combined CL/EBIC/DLTS investigation of a regular dislocation network formed by Si wafer direct bonding / X. Yu, O. Vyvenko, M. Kittler et al. // *Физика и механика полупроводников.* — 2007. — Vol. 41, no. 4. — Pp. 471–474.
397. Electronic States of Oxygen-free Dislocation Networks Produced by Direct Bonding of Silicon Wafers / M. Trushin, O. Vyvenko, T. McHedlidze et al. // *Solid State Phenomena.* — 2010. — Vol. 156–158. — Pp. 283–288.
398. *Kittler, Martin.* Dislocations as Active Components in Novel Silicon Devices / Martin Kittler, Manfred Reiche // *Advanced Engineering Materials.* — 2009. — Apr. — Vol. 11, no. 4. — Pp. 249–258.

399. Combined CL/EBC/DLTS investigation of a regular dislocation network formed by Si wafer direct bonding / X. Yu, O. Vyvenko, M. Kittler et al. // *Semiconductors*. — 2007. — Apr. — Vol. 41, no. 4. — Pp. 458–461.
400. Recombination properties of dislocations in GaN / Eugene B. Yakkimov, Alexander Y. Polyakov, In-Hwan Lee, Stephen J. Pearton // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Apr. — Vol. 123, no. 16. — P. 161543.
401. Green, Martin A. General temperature dependence of solar cell performance and implications for device modelling / Martin A. Green // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*. — 2003. — Aug. — Vol. 11, no. 5. — Pp. 333–340.
402. Dupre, O. Sol. Energy Mater. Sol. Cells / O. Dupre, R. Vaillon, M.A. Green // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*. — 2015. — Sep. — Vol. 140. — Pp. 92–100.
403. Green, Martin A. Optical properties of intrinsic silicon at 300 K / Martin A. Green, Mark J. Keevers // *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*. — 1995. — Vol. 3, no. 3. — Pp. 189–192.
404. Ellipsometric determination of optical constants for silicon and thermally grown silicon dioxide via a multi-sample, multi-wavelength, multi-angle investigation / C. M. Herzinger, B. Johs, W. A. McGahan et al. // *J. Appl. Phys.* — 1998. — Mar. — Vol. 83, no. 6. — Pp. 3323–3336.
405. Green, Martin A. Self-consistent optical parameters of intrinsic silicon at 300 K including temperature coefficients / Martin A. Green // *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*. — 2008. — Nov. — Vol. 92, no. 11. — Pp. 1305–1310.
406. Кизель, В.А. Отражение света / В.А. Кизель. — М.: Наука, 1973. — 352 с.
407. Коротченко, О.О. Ультразвуковой всплеск на спектре відбиття світла епітаксіальних шарів GaAs / О.О. Коротченко, О.М. Антонов // УФЖ. — 1994. — Т. 39, № 6. — С. 667–668.
408. Rhoderick, E. H. Metal–Semiconductor Contacts / E. H. Rhoderick, R. H. Williams. — Second edition. — Oxford: Clarendon Press, 1988. — 252 pp.

409. Norde, H. A modified forward I-V plot for Schottky diodes with high series resistance / H. Norde // *J. Appl. Phys.* — 1979. — Jul. — Vol. 50, no. 7. — Pp. 5052–5053.
410. Lien, C. D. An improved forward I-V method for nonideal Schottky diodes with high series resistance / C. D. Lien, F.C.T. So, M.A. Nicolet // *IEEE Trans. Electron Devices*. — 1984. — Oct. — Vol. ED-31, no. 10. — Pp. 1502–1503.
411. Werner, Jurgen H. Schottky Barrier and pn-Junction IV Plots—Small Signal Evaluation / Jurgen H. Werner // *Appl. Phys. A*. — 1988. — Nov. — Vol. 47, no. 3. — Pp. 291–300.
412. Cheung, S.K. Extraction of Schottky diode parameters from forward current-voltage characteristics / S.K. Cheung, N. W. Cheung // *Appl. Phys. Lett.* — 1986. — Jul. — Vol. 49, no. 2. — Pp. 85–87.
413. Gromov, D. Modified methods for the calculation of real Schottky-diode parameters / D. Gromov, V. Pugachevich // *Appl. Phys. A*. — 1994. — Sep. — Vol. 59, no. 3. — Pp. 331–333.
414. A systematic approach to the measurement of ideality factor, series resistance, and barrier height for Schottky diodes / T. C. Lee, S. Fung, C.D. Beling, H.L. Au // *J. Appl. Phys.* — 1992. — Nov. — Vol. 72, no. 10. — Pp. 4739–4742.
415. Bohlin, K. E. Generalized Norde plot including determination of the ideality factor / K. E. Bohlin // *J. Appl. Phys.* — 1986. — Aug. — Vol. 60, no. 3. — Pp. 1223–1224.
416. Cibils, Roberto M. Forward I-V plot for nonideal Schottky diodes with high series resistance / Roberto M. Cibils, Roman H. Buitrago // *J. Appl. Phys.* — 1985. — Jul. — Vol. 58, no. 2. — Pp. 1075–1077.
417. Schottky diode: Comments concerning the diode parameters determination from the forward I-V plot / J.-C. Manificat, N. Brorby, R. Ardebili, J.-P. Charles // *J. Appl. Phys.* — 1988. — Sep. — Vol. 64, no. 5. — Pp. 2502–2504.

418. On the extraction of linear and nonlinear physical parameters in nonideal diodes / V. Mikhelashvili, G. Eisenstein, V. Gaither et al. // *J. Appl. Phys.* — 1999. — May. — Vol. 85, no. 9. — Pp. 6873–6883.
419. Kaminski, A. I-V methods to extract junction parameters with special emphasis on low series resistance / A. Kaminski, J.J. Marchand, A. Laugier // *Solid-State Electron.* — 1999. — Apr. — Vol. 43, no. 4. — Pp. 741–745.
420. A generalized model for a two-terminal device and its applications to parameter extraction / A.. Ortiz-Conde, F.J. Garsia Sanchez, J.J. Liou et al. // *Solid-State Electron.* — 1995. — Jan. — Vol. 38, no. 1. — Pp. 265–266.
421. Durmus, Haziret. Extraction of voltage-dependent series resistance from I-V characteristics of Schottky diodes / Haziret Durmus, Ulfet Atav // *Appl. Phys. Lett.* — 2011. — Aug. — Vol. 99, no. 9. — P. 093505.
422. On a rapidly converging iterative algorithm for diode parameter extraction from a single IV curve / Enrico Cataldo, Alberto Di Lieto, Francesco Maccarone, Giampiero Paffuti // *J. Phys. Commun.* — 2017. — Dec. — Vol. 1, no. 5. — P. 055008.
423. Sato, K. Study of forward /-V plot for Schottky diodes with high series resistance / K. Sato, Y. Yasumura // *J. Appl. Phys.* — 1985. — Nov. — Vol. 58, no. 9. — Pp. 3655–3657.
424. Lyakas, M. Analysis of nonideal Schottky and p-n junction diodes — Extraction of parameters from I-V plots / M. Lyakas, R. Zaharia, M. Eizenberg // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Nov. — Vol. 78, no. 9. — Pp. 5481–5489.
425. Direct extraction of semiconductor device parameters using lateral optimization method / A.. Ortiz-Conde, Y. Ma, J. Thomson et al. // *Solid-State Electron.* — 1999. — Apr. — Vol. 43, no. 4. — Pp. 845–848.
426. Extraction of Schottky diode (and p-n junction) parameters from I-V characteristics / E.K. Evangelou, L. Papadimitriou, C.A. Dimitriades, G.E. Giakoumakis // *Solid-State Electron.* — 1993. — Nov. — Vol. 36, no. 11. — Pp. 1633–1635.

427. A self-consistent approach to ΓV-measurements on rectifying metal-semiconductor contacts / D. Donoval, J. de Sousa Pires, P.A. Tove, R. Harman // *Solid-State Electron.* — 1989. — Nov. — Vol. 32, no. 11. — Pp. 961–964.
428. Extraction of Schottky diode parameters including parallel conductance using a vertical optimization method / A. Ferhat-Hamida, Z. Ouennoughi, A. Hoffmann, R. Weiss // *Solid-State Electron.* — 2002. — May. — Vol. 46, no. 5. — Pp. 615–619.
429. Jung, W. Schottky diode parameters extraction using Lambert W function / W. Jung, M. Guziewicz // *Materials Science and Engineering: B.* — 2009. — Nov. — Vol. 165, no. 1–2. — Pp. 57–59.
430. Ortiz-Conde, Adelmo. Extraction of non-ideal junction model parameters from the explicit analytic solutions of its I-V characteristics / Adelmo Ortiz-Conde, Francisco J. Garsia Sanchez // *Solid-State Electron.* — 2005. — Mar. — Vol. 49, no. 3. — Pp. 465–472.
431. Дубинов, А. Е. W-функция Ламберта и ее применение в математических задачах физики / А. Е. Дубинов, И. Д. Дубинова, К. С. Сайков. — Саров: ФГУП «РФИЦ-ВНИИЭФ», 2006. — 160 с.
432. Ye, Meiyng. Parameter extraction of solar cells using particle swarm optimization / Meiyng Ye, Xiaodong Wang, Yousheng Xu // *J. Appl. Phys.* — 2009. — May. — Vol. 105, no. 9. — P. 094502.
433. Li, Yiming. An automatic parameter extraction technique for advanced CMOS device modeling using genetic algorithm / Yiming Li // *Microelectron. Eng.* — 2007. — Feb. — Vol. 84, no. 2. — Pp. 260–272.
434. A critical evaluation of EA computational methods for Photovoltaic cell parameter extraction based on two diode model / Kashif Ishaque, Zainal Salam, Hamed Taheri, Amir Shamsudin // *Solar Energy.* — 2011. — Sep. — Vol. 85, no. 9. — Pp. 1768–1779.
435. Patel, Sanjaykumar J. Extraction of solar cell parameters from a single current-voltage characteristic using teaching learning based optimization algorithm /

- Sanjaykumar J. Patel, Ashish K. Panchal, Vipul Kheraj // *Applied Energy*. — 2014. — Apr. — Vol. 119. — Pp. 384–393.
436. *Karaboga, Nurhan*. The parameter extraction of the thermally annealed Schottky barrier diode using the modified artificial bee colony / Nurhan Karaboga, Serdar Kockanat, Hulya Dogan // *Appl. Intell.* — 2013. — Apr. — Vol. 38, no. 3. — Pp. 279–288.
437. *Wang, Kaier*. Parameter estimation of Schottky–barrier diode model by particle swarm optimization / Kaier Wang, Meiyng Ye // *Int. J. Mod. Phys. C*. — 2009. — May. — Vol. 20, no. 5. — Pp. 687–699.
438. *Sellai, A*. Extraction of illuminated solar cell and Schottky diode parameters using a genetic algorithm / A. Sellai, Z. Ouennoughi // *Int. J. Mod. Phys. C*. — 2005. — Jul. — Vol. 16, no. 7. — Pp. 1043–1050.
439. *Roy, Indrajit G*. On estimating differential conductance from noisy I–V measurements in delineating device parameters / Indrajit G. Roy // *Acta Electrotechnica et Informatica*. — 2017. — Dec. — Vol. 17, no. 4. — Pp. 3–8.
440. *Mikhailashvili, V*. Simplified parameter extraction method for single and back-to-back Schottky diodes fabricated on silicon-on-insulator substrates / V. Mikhailashvili, R. Padmanabhan, G. Eisenstein // *J. Appl. Phys.* — 2017. — Jul. — Vol. 122, no. 3. — P. 034503.
441. *Aubry, V*. Schottky diodes with high series resistance: Limitations of forward I–V methods / V. Aubry, F. Meyer // *J. Appl. Phys.* — 1994. — Dec. — Vol. 76, no. 12. — Pp. 7973–7984.
442. Determination of the Schottky barrier height in diodes based on Au–TiB₂–n–SiC 6H from the current–voltage and capacitance–voltage characteristics / Ya. Ya. Kudryk, V. V. Shynkarenko, V. S. Slipukurov et al. // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2014. — Vol. 17, no. 4. — Pp. 398–402.
443. *Kalitkin, Н. Н*. Численные методы / Н. Н. Калиткин. — Санкт–Петербург: «БХВ–Петербург», 2011. — 592 c.

444. *Aboelfotoh, M.O*. Electrical characteristics of W–Si(100) Schottky barrier junctions / M.O. Aboelfotoh // *J. Appl. Phys.* — 1989. — Jul. — Vol. 66, no. 1. — Pp. 262–272.
445. A BEEM study of the temperature dependence of the barrier height distribution in PtSi/n–Si Schottky diodes / S. Zhua, R. L. Van Meirhaeghe, C. Detaverniera et al. // *Solid State Commun.* — 1999. — Oct. — Vol. 112, no. 11. — Pp. 611–615.
446. Temperature dependence of the indirect bandgap in ultrathin strained silicon on insulator layer / J. Munguia, J.-M. Bluet, O. Marty et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2012. — Mar. — Vol. 100, no. 10. — P. 102107.
447. Temperature dependence of the ideality factor of GaAs and Si Schottky diodes / T. C. Lee, T. P. Chen, H. L. Au et al. // *Phys. Status Solidi A*. — 1995. — Dec. — Vol. 152, no. 2. — Pp. 563–571.
448. Barrier characteristics of PtSi/p–Si Schottky diodes as determined from I–V–T measurements / P. G. McCafferty, A. Sellai, P. Dawson, H. Elabd // *Solid-State Electron.* — 1996. — Apr. — Vol. 39, no. 4. — Pp. 583–592.
449. *Saxena, A.N*. Forward current–voltage characteristics of Schottky barriers on n–type silicon / A.N. Saxena // *Surf. Sci.* — 1969. — Jan. — Vol. 13, no. 1. — Pp. 151–171.
450. Analysis of the temperature dependence of the forward voltage characteristics of GaInN light-emitting diodes / David S. Meynard, Jaehie Cho, E. Fred Schubert et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2013. — Sep. — Vol. 103, no. 12. — P. 121103.
451. Temperature dependence and effect of series resistance on the electrical characteristics of a polycrystalline diamond metal–insulator–semiconductor diode / W. P. Kang, J. L. Davidson, Y. Gurbutz, D. V. Kerns // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Jul. — Vol. 78, no. 2. — Pp. 1101–1107.
452. Effects of temperature on series resistance determination of electrodeposited Cr/n–Si/Au–Sb Schottky structures / O. Dermircioğlu, S. Karatas, N. Yıldırım, O.F. Balkaloglu // *Microelectron. Eng.* — 2011. — Sep. — Vol. 88, no. 9. — Pp. 2997–3002.

453. *Tung, Raymond T.* Recent advances in Schottky barrier concept / Raymond T. Tung // *Materials Science and Engineering: R. Reports.* — 2001. — Nov. — Vol. 35, no. 1–3. — Pp. 1–138.
454. *Dokme, İlbilge.* On the intersecting behaviour of experimental forward bias current–voltage (I–V) characteristics of Al/SiO₂/p-Si (MIS) Schottky diodes at low temperatures / İlbilge Dokme, Semsettin Altindal // *Semicond. Sci. Technol.* — 2006. — Vol. 21, no. 8. — Pp. 1053–1058.
455. *Colinge, J.P.* Physics of Semiconductor Device / J.P. Colinge, C.A. Colinge. — New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer academic publishers, 2002. — 436 pp.
456. *Cmrxha, B.I.* Контактные явления в полупроводниках / B.I. Стриха. — Киев: Вища школа, 1982. — 224 с.
457. Dislocation–governed current–transport mechanism in Ni(Au)–AlGaN/AlN/GaN heterostructures / Engin Arslan, Semsettin Altindal, Süleyman Özçelik, Ekmel Ozbay // *J. Appl. Phys.* — 2009. — Jan. — Vol. 105, no. 2. — P. 023705.
458. Current transport and barrier height evaluation in Ni/InAlN/GaN Schottky diodes / D. Donoval, A. Chvála, R. Šramatý et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2010. — May. — Vol. 96, no. 22. — P. 223501.
459. Study of the leakage current mechanism in Schottky contacts to Al_{0.25}Ga_{0.75}N/GaN heterostructures with AlN interlayers / Sen Huang, Bo Shen, Fu-Jun Xu et al. // *Semicond. Sci. Technol.* — 2009. — May. — Vol. 24, no. 5. — P. 055005.
460. Туннельно–избыточный ток в невырожденных барьерных $p - n$ - и $n - p$ -структурах Al^{III}Bi^V на Si / B.B. Евстропов, Ю.В. Жильев, М. Джурамбаев, Н. Назаров // *Физика и техника полупроводников.* — 1997. — Т. 31, № 2. — С. 152–158.
461. *Lee, Chang Hyun.* Carrier transport through boron–doped amorphous diamond-like carbon p layer of amorphous silicon based p-i-n solar cells / Chang Hyun Lee, Koeng Su Lim // *Appl. Phys. Lett.* — 1999. — Jul. — Vol. 75, no. 4. — Pp. 569–571.

462. *Sathaiya, D. Mahaveer.* Thermionic trap–assisted tunneling model and its application to leakage current in nitrided oxides and AlGaN/GaN high electron mobility transistors / D. Mahaveer Sathaiya, Shreepad Karmalkar // *J. Appl. Phys.* — 2006. — May. — Vol. 99, no. 9. — P. 093701.
463. Correlation between barrier inhomogeneities of 4H-SiC 1A/600V Schottky rectifiers and deep-level defects revealed by DLTS and Laplace DLTS / L. Geleruk, P. Kamyczek, E. Płaczek-Popko, M. Dąbrowska-Szata // *Solid-State Electron.* — 2014. — Mar. — Vol. 99. — Pp. 1–6.
464. Influence of swift heavy ion irradiation on electrical characteristics of Au/n-Si (100) Schottky barrier structure / Sandeep Kumar, Y. S. Katharria, Y. Batra, D. Kanjilal // *Journal of Physics D: Applied Physics.* — 2007. — Nov. — Vol. 40, no. 22. — Pp. 6892–6897.
465. Effect of 8 MeV Electrons on Au/n-Si Schottky diodes / A. Rao, S. Krishnan, G. Sanjeev, K. Siddappa // *Int. J. Pure Appl. Phys.* — 2009. — Vol. 5, no. 1. — Pp. 55–62.
466. *Kumar, Sandeep.* Swift heavy ion irradiation–induced defects and electrical characteristics of Au/n-Si Schottky structure / Sandeep Kumar, Y. S. Katharria, D. Kanjilal // *Journal of Physics D: Applied Physics.* — 2008. — May. — Vol. 41, no. 10. — P. 105105.
467. In-situ current–voltage analysis of Au/GaAs Schottky diode under nitrogen ion irradiation / A.T. Sharma, Shah Nawaz, Sandeep Kumar et al. // *Surf. Coat. Technol.* — 2009. — Vol. 203, no. 17–18. — Pp. 2667–2669.
468. Radiation damage of SiC Schottky diodes by electron irradiation / H. Ohyama, K. Takakura, T. Watanabe et al. // *J. Mater. Sci.: Mater. Electron.* — 2005. — Vol. 16, no. 7. — Pp. 455–458.
469. *Tataroğlu, A.* ⁶⁰Co γ irradiation effects on the current–voltage (I–V) characteristics of Al/SiO₂/p-Si (MIS) Schottky diodes / A. Tataroğlu, S. Altindal,

- M.M. Bülbül // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* — 2006. — Dec. — Vol. 568, no. 2. — Pp. 863–868.
470. The role of ^{60}Co γ -ray irradiation on the interface states and series resistance in MIS structures / İlke Taşçıoğlu, Adem Tataroğlu, Akif Özbay, Semsettin Altindal // *Radiat. Phys. Chem.* — 2010. — Apr. — Vol. 79, no. 4. — Pp. 457–461.
471. Tataroğlu, A. Analysis of interface states and series resistance at MIS structure irradiated under ^{60}Co γ -rays / A. Tataroğlu, S. Antindal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* — 2007. — Oct. — Vol. 580, no. 3. — Pp. 1588–1593.
472. Tataroğlu, A. Electrical characteristics of ^{60}Co γ -ray irradiated MIS Schottky diodes / A. Tataroğlu, S. Altindal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B.* — 2006. — Nov. — Vol. 252, no. 2. — Pp. 257–262.
473. Karatas, S. Electrical properties of Sn/p-Si (MS) Schottky barrier diodes to be exposed to ^{60}Co γ -ray source / S. Karatas, A. Turut // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* — 2006. — Oct. — Vol. 566, no. 2. — Pp. 584–589.
474. Annealing of ^{60}Co gamma radiation-induced damage in n-GaN Schottky barrier diodes / G. A. Umama-Membreno, J. M. Dell, G. Parish et al. // *J. Appl. Phys.* — 2007. — Mar. — Vol. 101, no. 5. — P. 054511.
475. Radiation effect on pn-SiC diode as a detector / Akimasa Kinoshita, Motohiro Iwami, Kenichi Kobayashi et al. // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A.* — 2005. — Apr. — Vol. 541, no. 1–2. — Pp. 213–220.
476. Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al-n-n⁺-Si-Al с барьером Шоттки / ГИ. Воробей, М.М. Воробей, В.Н. Стребежев и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2004. — Т. 38, № 6. — С. 690–692.
477. Effect of temperature and electron irradiation on the I–V characteristics of Au/CdTe Schottky diodes / Manjunatha Pattabi, Sheeba Krishnan, Ganesh, X. Mathew // *Solar Energy*. — 2007. — Jan. — Vol. 81, no. 1. — Pp. 111–116.

478. Влияние нейтронного облучения на фотоэлектрические параметры структур ИTO–GaSe / З.Д. Ковалюк, П.Г. Липовченко, О.А. Полипанская и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2007. — Т. 41, № 5. — С. 570–574.
479. Recovery of Electrical Characteristics of Au/n-Si Schottky Junction Under ^{60}Co Gamma Irradiation / S. Verma, K. C. Praveen, A. Bobby, D. Kanjilal // *IEEE Transactions on Device and Materials Reliability*. — 2014. — June. — Vol. 14, no. 2. — Pp. 721–725.
480. Salari, M. Abdolahpour. The effects of gamma irradiation on electrical characteristics of Zn/ZnO/n-Si/Au-Sb structure / M. Abdolahpour Salari, B. Güzeldir, M. Sağlam // *AIP Conference Proceedings*. — 2018. — Feb. — Vol. 1935, no. 1. — P. 050002.
481. Aging and degradation of aluminum–silicon structures with a Schottky barrier after a pulsed laser irradiation / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, A.P. Fedorenko, A.G. Shikavro // *Functional Materials*. — 2003. — Vol. 10, no. 3. — Pp. 468–473.
482. Стриха, В.И. Физические основы надежности контактов металлы–полупроводник в интегральной электронике / В.И. Стриха, Е. В. Бузанева. — М.: Радио и связь, 1987. — 253 с.
483. Soylu, M. Barrier characteristics of gold Schottky contacts on moderately doped n-InP based on temperature dependent I – V and C – V measurements / M. Soylu, B. Abay // *Microelectron. Eng.* — 2009. — Jan. — Vol. 86, no. 1. — Pp. 88–95.
484. Current–voltage and capacitance–voltage characteristics of Al Schottky contacts to strained Si-on-insulator in the wide temperature range / I. Jyothi, V. Janardhanam, Hyobong Hong, Chel-Jong Choi // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2015. — Nov. — Vol. 39. — Pp. 390–399.
485. A detailed study on current–voltage characteristics of Au/n-GaAs in wide temperature range / E. Özavci, S. Demirezen, U. Aydemir, S. Altindal // *Sens. Actuators, A.* — 2013. — May. — Vol. 194. — Pp. 259–268.
486. Effect of ^{60}Co γ -irradiation on the nature of electronic transport in heavily doped n-type GaN based Schottky photodetectors / Abhishek Chatterjee,

- Shailesh K. Khamari, S. Porwal et al. // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Apr. — Vol. 123, no. 16. — P. 161585.
487. *Bozhkov, V. G.* Influence of the nonlinear bias dependence of the barrier height on measured Schottky-barrier contact parameters / V. G. Bozhkov, A. V. Shmaragnov // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Jun. — Vol. 109, no. 11. — P. 113718.
488. *Aldemir, Durmus Ali*. Temperature dependent ideality factor and barrier height of Ni/n-GaAs/In Schottky diodes / Durmus Ali Aldemir, Ali Kokce, Ahmet Faruk Ozdemir // *Microelectron. Eng.* — 2012. — Oct. — Vol. 98. — Pp. 6–11.
489. Double Gaussian distribution of barrier height observed in densely packed GaN nanorods over Si (111) heterostructures / Lokesh Mohan, Greesima Chandan, Shruthi Mukundan et al. // *J. Appl. Phys.* — 2014. — Dec. — Vol. 116, no. 23. — P. 234508.
490. *Dökme, İlbilge*. The distribution of the barrier height in Al-TiW-Pd₂ Si/n-Si Schottky diodes from $I-V-T$ measurements / İlbilge Dökme, Şenşettin Altindal, Izett M Afandiyeva // *Semicond. Sci. Technol.* — 2008. — Mar. — Vol. 23, no. 3. — P. 035003.
491. *Sarpatwari, K.* Effects of barrier height inhomogeneities on the determination of the Richardson constant / K. Sarpatwari, S. E. Mohnley, O. O. Awadelkarim // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Jan. — Vol. 109, no. 01. — P. 014510.
492. *İlke Taşçıoğlu*. The explanation of barrier height inhomogeneities in Au/n-Si Schottky barrier diodes with organic thin interfacial layer / İlke Taşçıoğlu, Umut Aydemir, Şenşettin Altindal // *J. Appl. Phys.* — 2010. — Sep. — Vol. 108, no. 6. — P. 064506.
493. *Yıldırım, Nezir*. On temperature-dependent experimental I-V and C-V data of Ni/n-GaN Schottky contacts / Nezir Yıldırım, Kadir Ejderha, Abdulkemecit Tutar // *J. Appl. Phys.* — 2010. — Dec. — Vol. 108, no. 11. — P. 114506.
494. *Mamor, M.* Interface gap states and Schottky barrier inhomogeneity at metal/n-type GaN Schottky contacts / M. Mamor // *J. Phys.: Condens. Matter.* — 2009. — Aug. — Vol. 21, no. 33. — P. 335802.
495. Barrier inhomogeneity and electrical properties of Pt/GaN Schottky contacts / Ferdinando Iucolano, Fabrizio Roccaforte, Filippo Giannazzo, Vito Raineri // *J. Appl. Phys.* — 2007. — Dec. — Vol. 102, no. 11. — P. 113701.
496. Temperature behavior of inhomogeneous Pt/GaN Schottky contacts / F. Iucolano, F. Roccaforte, F. Giannazzo, V. Raineri // *Appl. Phys. Lett.* — 2007. — Feb. — Vol. 90, no. 9. — P. 092119.
497. Electron transport of inhomogeneous Schottky barriers: A numerical study / J. P. Sullivan, R. T. Tung, M. R. Pinto, W. R. Graham // *J. Appl. Phys.* — 1991. — Dec. — Vol. 70, no. 12. — Pp. 7403–7424.
498. *Tung, R. T.* Electron transport at metal-semiconductor interfaces: General theory / R. T. Tung // *Phys. Rev. B.* — 1992. — Jun. — Vol. 45, no. 23. — Pp. 13509–13523.
499. *Tung, Raymond T.* The physics and chemistry of the Schottky barrier height / Raymond T. Tung // *Applied Physics Reviews*. — 2014. — Mar. — Vol. 1, no. 1. — P. 011304.
500. *Durmus, Perihan*. Gaussian distribution of inhomogeneous barrier height in Au/n-Si (111) Schottky barrier diodes at low temperatures / Perihan Durmuş, Mert Yıldırım // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2014. — Nov. — Vol. 27. — Pp. 145–149.
501. Temperature dependent current-voltage characteristics of Au/n-type Ge Schottky barrier diodes with graphene interlayer / Zagarzusem Khurelbaatar, Min-Sung Kang, Kyu-Hwan Shim et al. // *J. Alloys Compd.* — 2015. — Nov. — Vol. 650. — Pp. 658–663.
502. *Cetin, Hidayet*. Temperature dependence of electrical parameters of the Au/n-InP Schottky barrier diodes / Hidayet Cetin, Emise Ayıldız // *Semicond. Sci. Technol.* — 2005. — Jun. — Vol. 20, no. 6. — Pp. 625–631.

503. *Li, Ang. J.* Moderately-doped Schottky barriers: a description using thermionic emission over a wide temperature range / Ang. J. Li, Arthur. F. Hebard // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 2016. — Nov. — Vol. 49, no. 45. — P. 455101.
504. *Schmitsdorf, R. F.* Explanation of the linear correlation between barrier heights and ideality factors of real metal–semiconductor contacts by laterally nonuniform Schottky barriers / R. F. Schmitsdorf, T. U. Kampen, W. Mönch // *J. Vac. Sci. Technol. B*. — 1997. — Jul. — Vol. 15, no. 4. — Pp. 1221–1226.
505. Ni/Si solid phase reaction studied by temperature-dependent current–voltage technique / Yu-Long Jiang, Guo-Ping Ru, Fang Lu et al. // *J. Appl. Phys.* — 2003. — Jan. — Vol. 93, no. 2. — Pp. 866–870.
506. *Andrews, J.M.* Reverse current–voltage characteristics of metal–silicide Schottky diodes / J.M. Andrews, M.P. Lepsetter // *Solid-State Electron.* — 1970. — Julie. — Vol. 13, no. 7. — Pp. 1011–1023.
507. Механизм токопрохождения в электролюминесцентных структурах полистый кремний / монокристаллический кремний / А.А. Евзух, Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, Н.А. Семененко // *Физика и техника полупроводников*. — 2006. — Т. 40, № 2. — С. 180–184.
508. *Новиков, Ю.Н.* Энергонезависимая память, основанная на кремниевых нанокластерах / Ю.Н. Новиков // *Физика и техника полупроводников*. — 2009. — Т. 43, № 8. — С. 1078–1083.
509. *Куриосова, О.В.* Туннелирование с глубоких примесных центров в электрическом поле в полупроводниках AlPbV / О.В. Куриосова, А.А. Пахомов // *Физика и техника полупроводников*. — 1986. — Т. 20, № 10. — С. 1868–1874.
510. *Буярский, С.В.* Анализ механизмов переноса тока, определяющих характер обратных вольт–амперных характеристик барьера метал–GaAs / С.В. Буярский, А.В. Жуков // *Физика и техника полупроводников*. — 2001. — Т. 35, № 5. — С. 560–563.
511. *Василов, В.С.* Дефекты в кремнии и на его поверхности / В.С. Василов, В.Ф. Киселев, Б.Н. Мукампев. — М.: Наука, 1990. — 216 с.
512. *Song, L.W.* Identification of a bistable defect in silicon: The carbon interstitial–carbon substitutional pair / L.W. Song, B.W. Benson, G.D. Watkins // *Appl. Phys. Lett.* — 1987. — Oct. — Vol. 51, no. 15. — Pp. 1155–1157.
513. Temperature dependent electrical transport behavior of InN/GaN heterostructure based Schottky diodes / Bassanta Roul, Mohana K. Rajpalke, Thirumaleshwara N. Bhat et al. // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Feb. — Vol. 109, no. 4. — P. 044502.
514. *Музафарова, С.А.* Влияние γ -облучения на механизм переноса тока в гетероструктурах n–CdS/p–CdTe / С.А. Музафарова, Ш.А. Мирсагатов, Ф.Н. Джакаматов // *Физика и техника полупроводников*. — 2009. — Т. 43, № 2. — С. 187–192.
515. Gamma irradiation-induced changes at the electrical characteristics of organic-based Schottky structures / O. Gullu, M. Cankaya, M. Bibi, A. Turut // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 2008. — Jul. — Vol. 41, no. 13. — P. 135103.
516. *Karatas, S.* Effects of ^{60}Co γ -ray irradiation on the electrical characteristics of Au/n-GaAs (MS) structures / S. Karatas, A. Turut, S. Altindal // *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A*. — 2005. — Dec. — Vol. 555, no. 1–2. — Pp. 260–265.
517. Distinction between the Poole–Frenkel and tunneling models of electric-field-stimulated carrier emission from deep levels in semiconductors / S. D. Ganichev, E. Ziemann, W. Prettl et al. // *Phys. Rev. B*. — 2000. — Apr. — Vol. 61, no. 15. — Pp. 10361–10365.
518. *Ганичев, С.Д.* Ионизация глубоких примесных центров дальним инфракрасным излучением / С.Д. Ганичев, И.Н. Яссинич, В. Преттл // *Физика твердого тела*. — 1997. — Т. 39, № 11. — С. 1905–1932.
519. The role of the tunneling component in the current–voltage characteristics of metal–GaN Schottky diodes / L. S. Yu, Q. Z. Liu, Q. J. Xing et al. // *J. Appl. Phys.* — 1998. — Aug. — Vol. 84, no. 4. — Pp. 2099–2104.

520. Особенности образования радиационных дефектов в слое кремния структур «кремний на изолиторе» / К.Д. Шербаев, В.Т. Бублик, В.Н. Мордкович, Д.М. Пажин // *Физика и техника полупроводников*. — 2011. — Т. 45, № 6. — С. 738–742.
521. Vorobets, G.I. Laser manipulation of clusters, structural defects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semi-conductors / G.I. Vorobets, O.I. Vorobets, V.N. Strebbegev // *Appl. Surf. Sci.* — 2005. — Jul. — Vol. 247, no. 1–4. — Pp. 590–601.
522. Expansion of Shockley stacking fault observed by scanning electron microscope and partial dislocation motion in 4H-SiC / Yoshifumi Yamashita, Ryu Nakata, Takeshi Nishikawa et al. // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Apr. — Vol. 123, no. 16. — P. 161580.
523. Релаксация внутренних механических напряжений в арсенидгалиевыеих приборных структурах, стимулированная микроволновой обработкой / Н.С. Болговец, А.Б. Камалов, Е.Ю. Колядина и др. // *Письма в журнал механической физики*. — 2002. — Т. 28, № 4. — С. 57–64.
524. Использование методом электроотражения влияния γ -облучения на оптические свойства epitаксиальных пленок GaN / А.Е. Беляев, Н.И. Клой, Р.В. Конакова и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2012. — Т. 46, № 3. — С. 317–320.
525. Островский, I.B. Физична акустооптика / I.B. Островський, О.О. Коротченко. — К.: ВІУ «Київський університет», 2000. — 347 с.
526. Singh, R. Swift heavy ion irradiation induced modification of electrical characteristics of Au/n-Si Schottky barrier diode / R. Singh, S.K. Arora, D. Kanjilal // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2001. — Oct. — Vol. 4, no. 5. — Pp. 425–432.
527. Coupling Light into Graphene Plasmons through Surface Acoustic Waves / Jürgen Schiefele, Jorge Pedros, Fernando Sols et al. // *Phys. Rev. Lett.* — 2013. — Dec. — Vol. 111, no. 23. — P. 237405.

528. Ultrasonicated double wall carbon nanotubes for enhanced electric double layer capacitance / Srikrishna Pandey, Uday N. Maiti, Kowsalya Palanisamy et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2014. — Jun. — Vol. 104, no. 23. — P. 233902.
529. Raeymakers, Bart. Manipulation of diamond nanoparticles using bulk acoustic waves / Bart Raeymakers, Cristian Pannea, Dipen N. Sinha // *J. Appl. Phys.* — 2011. — Jan. — Vol. 109, no. 1. — P. 014317.
530. Ultrahigh-frequency surface acoustic wave generation for acoustic charge transport in silicon / S. Buyukkose, B. Vratzov, J. van der Veen et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2013. — Jan. — Vol. 102, no. 1. — P. 013112.
531. He, Jian-Hong. Correlated electron transport assisted by surface acoustic waves in micron-separated quasi-one-dimensional channels / Jian-Hong He, Jie Gao, Hua-Zhong Guo // *Appl. Phys. Lett.* — 2010. — Sep. — Vol. 97, no. 12. — P. 122107.
532. Savkina, R.K. Semiconductor surface structurization induced by ultrasound / R.K. Savkina // *Funcional Materials*. — 2012. — Vol. 19, no. 1. — Pp. 38–43.
533. Savkina, R.K. Properties of the crystalline silicon strained via cavitation impact / R.K. Savkina // *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*. — 2013. — Vol. 16, no. 1. — Pp. 43–44.
534. Savkina, R.K. Образование нитридов на поверхности монокристаллического GaAs в криогенной жидкости при облучении ультразвуком / Р.К. Савкина, А.Б. Смирнов // *Письма в ЖТФ*. — 2015. — Т. 41, № 4. — С. 15–23.
535. Savkina, R. K. The photoresponse of crystalline silicon strained via ultrasonic cavitation processing / R. K. Savkina, A. B. Smirnov // *Phys. Status Solidi C*. — 2015. — Aug. — Vol. 12, no. 8. — Pp. 1090–1093.
536. Sonosynthesis of microstructures array for semiconductor photovoltaics / R.K. Savkina, A.B. Smirnov, T. Kryshchab, A. Kryukov // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2015. — Sep. — Vol. 37. — Pp. 179–184.

537. Savkina, R. K. Nitrogen incorporation into GaAs lattice as a result of the surface cavitation effect / R. K. Savkina, A. B. Smirnov // *J. Phys. D: Appl. Phys.* — 2010. — Oct. — Vol. 43, no. 42. — P. 425301.
538. Kryshtab, Tetyana G. Nanoscale Structuration of Semiconductor Surface Induced by Cavitation Impact / Tetyana G. Kryshtab, Rada K. Savkina, Alexey B. Smirnov // *MRS Proceedings*. — 2013. — Vol. 1534. — Pp. A87–A92.
539. Власенко, А. И. Подвижность носителей заряда в кристаллах $p\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ в условиях динамического ультразвукового нагружения / А.И. Власенко, Я.М. Олих, Р.К. Савкина // *Физика и техника полупроводников*. — 2000. — Т. 34, № 6. — С. 670–676.
540. Smith, R. T. Temperature Dependence of the Elastic, Piezoelectric, and Dielectric Constants of Lithium Tantalate and Lithium Niobate / R. T. Smith, F. S. Welsh // *J. Appl. Phys.* — 1971. — May. — Vol. 42, no. 6. — Pp. 2219–2230.
541. Ultrasonic study of vacancy in single crystal silicon at low temperatures / M. Akatsu, T. Goto, H. Y-Kaneta et al. // *Journal of Physics: Conference Series*. — 2009. — Vol. 150, no. 4. — P. 042002.
542. Unewisse, M. H. Conduction mechanisms in erbium silicide Schottky diodes / M. H. Unewisse, J. W. V. Storey // *J. Appl. Phys.* — 1993. — Apr. — Vol. 73, no. 8. — Pp. 3873–3879.
543. Korkut, H. Temperature-dependent current–voltage characteristics of Cr/n-GaAs Schottky diodes / H. Korkut, N. Yildirim, A. Turut // *Microelectron. Eng.* — 2009. — Jan. — Vol. 86, no. 1. — Pp. 111–116.
544. An Adjustable Work Function Technology Using Mo Gate for CMOS Devices / Ronald Lin, Qiang Lu, Pushkar Ranade et al. // *IEEE Electron Device Letters*. — 2002. — Jan. — Vol. 23, no. 1. — Pp. 49–51.
545. Temperature dependence of 1/f noise in Ni/n-GaN Schottky barrier diode / Ashutosh Kumar, K. Asokan, V. Kumar, R. Singh // *J. Appl. Phys.* — 2012. — Jul. — Vol. 112, no. 12. — P. 024507.

546. Schottky Barrier Height Inhomogeneity of Ti/n-GaAs Contact Studied by the I-V-T Technique / Yu-Long Jiang, Guo-Ping Ru, Fang Lu et al. // *Chin. Phys. Lett.* — 2002. — Apr. — Vol. 19, no. 4. — Pp. 553–556.
547. Yildirim, Nezir. The theoretical and experimental study on double–Gaussian distribution in inhomogeneous barrier–height Schottky contacts / Nezir Yildirim, Abdulmejid Turut, Nevise Turut // *Microelectron. Eng.* — 2010. — Nov. — Vol. 87, no. 11. — Pp. 2225–2229.
548. Modelling the inhomogeneous SiC Schottky interface / P. M. Gammon, A. Perez-Tomas, V. A. Shah et al. // *J. Appl. Phys.* — 2013. — Dec. — Vol. 114, no. 22. — P. 223704.
549. Труэлл, Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела / Р. Труэлл, Ч. Эльбдум, Б. Чик. — М.: Мир, 1972. — 307 с.
550. Никаноров, С.П. Упругость и дислокационная неупругость кристаллов / С.П. Никаноров, Б.К. Карданцев. — М.: Наука, 1985. — 252 с.
551. Granato, A. Theory of Mechanical Damping Due to Dislocations / A. Granato, K. Lücke // *J. Appl. Phys.* — 1956. — Jun. — Vol. 27, no. 6. — Pp. 583–593.
552. Судзуки, Т. Динамика дислокаций и пластичность / Т. Судзуки, Х. Ёсивара, С. Такеути. — М.: Мир, 1989. — 296 с.
553. Поглощение и скорость распространения ультразвука в нейтроннотепловом кремни / Я. М. Олих, А. Д. Беляев, Е. Г. Миселок и др. // *Электронная техника. Сер. 6: Материалы*. — 1983. — Т. 175, № 2. — С. 40–43.
554. Brailsford, A. D. Abrupt–Kink Model of Dislocation Motion / A. D. Brailsford // *Phys. Rev.* — 1961. — May. — Vol. 122, no. 3. — Pp. 778–786.
555. Loktev, V.M. On the nature of ionic crystals' sonoluminescence excitation threshold: point-defect generation / V.M. Loktev, Julia Khalack // *J. Lumin.* — 1998. — Feb. — Vol. 76–77. — Pp. 560–563.

556. Transport-mechanism analysis of the reverse leakage current in GaInN light-emitting diodes / Qifeng Shan, David S. Meyard, Qi Dai et al. // *Appl. Phys. Lett.* — 2011. — 10.1063/1.3668104. — Vol. 99, no. 25. — P. 253506.
557. Pipinys, P. Temperature dependence of reverse-bias leakage current in GaN Schottky diodes as a consequence of phonon-assisted tunneling / P. Pipinys, V. Lapeika // *J. Appl. Phys.* — 2006. — May. — Vol. 99, no. 9. — P. 093709. — Jan. — Vol. 35, no. 1. — P. 015009.
558. Low-leakage and NB₁₁-mitigated N -type domino logic / Liang Huaguo, Xu Hui, Huang Zhengfeng, Yi Maoxiang // *Journal of Semiconductors.* — 2014. — Jan. — Vol. 35, no. 1. — P. 015009.
559. Design of novel DDSCR with embedded PNP structure for ESD protection / Bi Xiuwen, Liang Hailian, Gu Xiaofeng, Huang Long // *Journal of Semiconductors.* — 2015. — Nov. — Vol. 36, no. 12. — P. 124007.
560. Abu-Samaha, F. S. Temperature dependent of the current-voltage (I-V) characteristics of TaSi₂/n-Si structure / F. S. Abu-Samaha, A. A. A. Darwish, A. N. Mansour // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2013. — Dec. — Vol. 16, no. 6. — Pp. 1988–1991.
561. Jafar; M M Abdul-Gader. High-bias current-voltage-temperature characteristics of undoped rf magnetron sputter deposited boron carbide (B₅C)/p-type crystalline silicon heterojunctions / M M Abdul-Gader Jafar // *Semicond. Sci. Technol.* — 2003. — Jan. — Vol. 18, no. 1. — Pp. 7–22.
562. Pipinys, P. Phonon-assisted tunneling in reverse biased Schottky diodes / P. Pipinys, A. Pipiniene, A. Rimeika // *J. Appl. Phys.* — 1999. — Dec. — Vol. 86, no. 12. — Pp. 6875–6878.
563. Пилинис, П.А. Температурная зависимость обратного тока в диодах с барьером Шоттки / П.А. Пилинис, А.К. Римейка, В.А. Лапейка // *Физика и техника полупроводников.* — 1998. — Т. 32, № 7. — С. 882–885.
564. Kiveris, A. Release of Electrons from Traps by an Electric Field with Phonon Participation / A. Kiveris, S. Kudzmauskas, P. Pipinys // *Phys. Status Solidi A.* — 1976. — Sep. — Vol. 37, no. 1. — Pp. 321–327.
565. Шалимова, К.В. Физика полупроводников / К.В Шалимова. — СПб: Издательство «Лань», 2010. — 400 с.
566. Electron spin resonance study of surface and oxide interface spin-triplet centers on (100) silicon wafers / H. Saito, S. Hayashi, Y. Kusano et al. // *J. Appl. Phys.* — 2018. — Apr. — Vol. 123, no. 16. — P. 161582.
567. Interface and transport properties of gamma irradiated Au/n-GaP Schottky diode / N. Shiwakoti, A. Bobby, K. Asokan, Bobby Antony // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2018. — Feb. — Vol. 74. — Pp. 1–6.
568. Electric field dependence of GaAs Schottky barriers / G.H. Parker, T.C. McGill, C.A. Mead, D. Hoffman // *Solid-State Electron.* — 1968. — Feb. — Vol. 11, no. 2. — Pp. 201–204.
569. Mitrofanov, Oleg. Poole-Frenkel electron emission from the traps in AlGaN/GaN transistors / Oleg Mitrofanov, Michael Manfra // *J. Appl. Phys.* — 2004. — Jun. — Vol. 95, no. 11. — Pp. 6414–6419.
570. Ионизация мелких примесей электрическим полем в случайному кулоновскому потенциале / Н.Г. Жданова, М.С. Каган, Е.Г. Ландеберг и др. // *Лисьма в ЖЭТФ.* — 1995. — Т. 62, № 2. — С. 108–111.
571. Коршунов, Ф.П. Воздействие радиации на интегральные микросхемы / Ф.П. Коршунов, Ю.В. Богатырев, Вавилов В.А. — Минск: Наука и техника, 1986. — 254 с.
572. Modern Microwave Methods in Solid-State Inorganic Materials Chemistry: From Fundamentals to Manufacturing / Helen J. Kitchen, Simon R. Vallance, Jennifer L. Kennedy et al. // *Chem. Rev.* — 2014. — Vol. 114, no. 2. — Pp. 1170–1206.
573. СВЧ нагрев как метод термообработки полупроводников / А.В. Ржанов, Н.Н. Герасименко, С.В. Васильев, В.И. Ободников // *Листья в журнале технической физики.* — 1981. — Т. 7, № 20. — С. 1221–1223.

574. Paton, Boris E. Gyrotron Processing of Materials / Boris E. Paton, Vladislav E. Sklyarevich, Marko M.G. Slusarczuk // *MRS Bulletin*. — 1993. — Nov. — Vol. 18, no. 11. — Pp. 58–63.
575. Использование мощного СВЧ излучения для отжига арсенида галия / Е.В. Винник, В.И. Гуроцев, А.В. Прохорович, М.В. Шевелев // *Омнозелектроника и полупроводниковая техника*. — 1989. — Т. 15. — С. 48–50.
576. Thermal processing of silicon wafers with microwave co-heating / H. Zohm, E. Kasper, P. Mehringer, G.A. Müller // *Microelectron. Eng.* — 2000. — Dec. — Vol. 54, no. 3–4. — Pp. 247–253.
577. Bhunia, S. Microwave synthesis, single crystal growth and characterization of ZnTe / S. Bhunia, D.N. Bose // *J. Cryst. Growth*. — 1998. — Mar. — Vol. 186, no. 4. — Pp. 535–542.
578. Влияние сверхвысокочастотного отжига на структуры двуокись кремни-карбид кремния / Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, А.Н. Коцеров и др. // *Журнал технической физики*. — 2003. — Т. 73, № 5. — С. 75–78.
579. Пашков, В.И. Влияние отжига в поле СВЧ излучения на остаточную деформацию и примесный состав приповерхностных слоев кремния / В.И. Пашков, В.А. Перевощиков, В.Д. Скулов // *Листья в журнале технической физики*. — 1994. — Т. 20, № 8. — С. 14–18.
580. Немоногонность процессов структурной релаксации при СВЧ обработке арсенида галлия / Т.Г. Крыштаб, Г.Н. Семенова, П.М. Литвин и др. // *Омнозелектроника и полупроводниковая техника*. — 1996. — Т. 31. — С. 140–145.
581. Физико-химические процессы на границе раздела контактов Au/Pt/C_x/Pt/GaAs, подвергнутых СВЧ отжигу / В.В. Миленин, Р.В. Конакова, Б.А. Статов и др. // *Листья в журнале технической физики*. — 1994. — Т. 20, № 4. — С. 32–36.
582. Effect of microwave and laser radiations on the parameters of semiconductor structures / A.E. Belyaev, E.F. Venger, I.B. Ermolovich et al. — Kyiv: Intac, 2002. — 192 pp.
583. The effects of photogenerated free carriers and microwave electron heating on exciton dynamics in GaAsAlGaAs quantum wells / B.M. Ashkinadze, E. Cohen, Aliza Ron et al. // *Solid-State Electron*. — 1996. — Vol. 40, no. 1–8. — Pp. 561–565.
584. Photoluminescent investigations of SHF irradiation effect on defect states in GaAs:Sn(Te) and InP crystals / Irene B. Ermolovich, Evgenie F. Venger, Raisa V. Konakova et al. // *Proc. SPIE*. — 1998. — Vol. 3359. — Pp. 265–272.
585. Влияние внешних радиационных СВЧ и механических возбуждений на образование дефектов в неметаллических кристаллах / Е.Ф. Венгер, И.Б. Ермолович, В.В. Миленин и др. // *Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение*. — 1999. — № 2. — С. 60–72.
586. Влияние сверхвысокочастотной обработки на электрофизические характеристики технически важных полупроводников и поверхностно–барьерных структур / А.А. Беляев, А.Е. Беляев, И.Б. Ермолович и др. // *Журнал технической физики*. — 1998. — Т. 68, № 12. — С. 49–53.
587. Изменение характеристик оксидных пленок гадолиния, титана и эрбия на поверхности n-Si–SiC под воздействием сверхвысокочастотной обработки / Ю.Ю. Бачериков, Р.В. Конакова, В.В. Миленин и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2008. — Т. 42, № 7. — С. 888–892.
588. Структурные трансформации в гомо- и гетерогенных системах на основе GaAs, обусловленные СВЧ-облучением / Н.С. Заяц, Р.В. Конакова, В.В. Миленин и др. // *Журнал технической физики*. — 2015. — Т. 85, № 3. — С. 114–118.
589. Влияние микроволнового облучения на сопротивление омических контактов Au–TiB_x–Ge–Au–n–n⁺–n⁺⁺–GaAs(InP) / А.Е. Беляев, А.В. Саенко, Н.С. Болотовец и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2012. — Т. 46, № 4. — С. 558–561.

590. Ржанов, А. В. Характер энергетического спектра поверхностных состояний и кинетика импульсного эффекта поля / А. В. Ржанов // *Физика и техника полупроводников*. — 1972. — Т. 6, № 8. — С. 1495–1501.
591. Godwod, K. The application of the X-ray triple-crystal spectrometer for measuring the radius of curvature of bent single crystals / K. Godwod, A. T. Nagy, Z. Rek // *Phys. Status Solidi A*. — 1976. — Apr. — Vol. 34, no. 2. — Pp. 705–710.
592. Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах (механизмы релаксации, методы исследования, роль в детралиции приборов) / Е. Ф. Венгер, М. Грендель, В. Данилова и др.; Под ред. Ю.А. Тхорика. — Киев: Видавництво «Фенікс», 1994. — 246 с.
593. Pavlović, M. Complete set of deep traps in semi-insulating GaAs / M. Pavlović, U. V. Desnica, J. Gladić // *J. Appl. Phys.* — 2000. — Oct. — Vol. 88, no. 8. — Pp. 4563–4570.
594. Булярский, С.В. Полевая зависимость скорости термической эмиссии дырок с комплекса $V_{\text{Ga}}S_{\text{As}}$ в арсениде галлия / С.В. Булярский, Н.С. Грушко, А.В. Жуков // *Физика и техника полупроводников*. — 2000. — Т. 34, № 1. — С. 41–45.
595. Makram-Ebeid, S. Quantum model for phonon-assisted tunnel ionization of deep levels in a semiconductor / S. Makram-Ebeid, M. Lannoo // *Phys. Rev. B*. — 1982. — May. — Vol. 25. — Pp. 6406–6424.
596. Шишиян, Ф.С. Диффузия и деградация в полупроводниковых материалах и приборах / Ф.С. Шишиян. — Кишинев: Штиница, 1978. — 230 с.
597. Defects and defect behaviour in GaAs grown at low temperature / M. Stellmacher, R. Bisaro, P. Galtier et al. // *Semicond. Sci. Technol.* — 2001. — Jun. — Vol. 16, no. 6. — Pp. 440–446.
598. Bourgoin, J. C. The defect responsible for non-radiative recombination in GaAs materials / J. C. Bourgoin, N. De Angelis // *Semicond. Sci. Technol.* — 2001. — Jun. — Vol. 16, no. 6. — Pp. 497–501.

599. Bourgoin, J. C. Native defects in gallium arsenide / J. C. Bourgoin, H. J. von Bardeleben, D. Stiévenard // *J. Appl. Phys.* — 1988. — Nov. — Vol. 64, no. 9. — Pp. R65–R92.
600. Лебедев, А.А. Центры с глубокими уровнями в карбите кремния. Обзор / А.А. Лебедев // *Физика и техника полупроводников*. — 1999. — Т. 33, № 2. — С. 129–155.
601. Высокотемпературный диод Шоттки Li–SiC–6H / М.М. Аникин, А.Н. Анидров, А.А. Лебедев и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 1991. — Т. 25, № 2. — С. 328–333.
602. Рекомбинационные процессы в 6H-SiC p-n-структур и влияние на них глубоких центров / М.М. Аникин, А.С. Зубрилов, А.А. Лебедев и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 1991. — Т. 25, № 3. — С. 479–486.
603. Кузнецов, Н.И. Влияние глубоких уровней на релаксацию тока в 6H-SiC-диодах / Н.И. Кузнецов, J.A. Edmond // *Физика и техника полупроводников*. — 1997. — Т. 31, № 10. — С. 1220–1224.
604. Радиационные дефекты в n-6H-SiC, облученном протонами с энергией 8 МэВ / А.А. Лебедев, А.И. Вейнгер, Д.В. Давыдов и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2000. — Т. 34, № 8. — С. 897–902.
605. Влияние степени структурного совершенства на спектр глубоких центров в 6H-SiC / А.А. Лебедев, Д.В. Давыдов, А.С. Трегубова и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2001. — Т. 35, № 12. — С. 1434–1436.
606. Hemmingsson, C. G. Observation of negative-U centers in 6H silicon carbide / C. G. Hemmingsson, N. T. Son, E. Janzen // *Appl. Phys. Lett.* — 1999. — Feb. — Vol. 74, no. 6. — Pp. 839–841.
607. Activation energies of the EL6 trap and of the 0.15 eV donor and their correlation in GaAs / T. Richter, G. Künnel, W. Siegel, J. R. Niklas // *Semicond. Sci. Technol.* — 2000. — Nov. — Vol. 15, no. 11. — Pp. 1039–1044.

608. Neild, S. T. Signature of the gallium–oxygen–gallium defect in GaAs by deep level transient spectroscopy measurements / S. T. Neild, M. Skowronski, J. Lagowski // *Appl. Phys. Lett.* — 1991. — Feb. — Vol. 58, no. 8. — Pp. 859–861.
609. Schultz, Peter A. The E 1–E 2 center in gallium arsenide is the divacancy / Peter A. Schultz // *J. Phys.: Condens. Matter.* — 2015. — Feb. — Vol. 27, no. 7. — P. 075801.
610. Electron irradiation induced defects and schottky diode characteristics for metalorganic vapor phase epitaxy and molecular beam epitaxial n-GaAs / G. H. Yousefi, J. B. Webb, R. Rousina, S. M. Khanna // *J. Electron. Mater.* — 1995. — Jan. — Vol. 24, no. 1. — Pp. 15–20.
611. Microscopic nature of thermally stimulated current and electrical compensation in semi-insulating GaAs / S. Kuisima, K. Saarinen, P. Hautojärvi et al. // *J. Appl. Phys.* — 1997. — Apr. — Vol. 81, no. 8. — Pp. 3512–3521.
612. Pavlović, M. Precise determination of deep trap signatures and their relative and absolute concentrations in semi-insulating GaAs / M. Pavlović, U. V. Desnica // *J. Appl. Phys.* — 1998. — Aug. — Vol. 84, no. 4. — Pp. 2018–2024.
613. Tomozane, Mamoru. Improved Thermally Stimulated Current Spectroscopy to Characterize Levels in Semi-Insulating GaAs / Mamoru Tomozane, Yasuo Naniichi // *Japanese Journal of Applied Physics.* — 1986. — Apr. — Vol. 25, no. 4. — Pp. L273–L275.
614. Study of electron traps in n-GaAs grown by molecular beam epitaxy / D. V. Lang, A. Y. Cho, A. C. Gossard et al. // *J. Appl. Phys.* — 1976. — Jun. — Vol. 47, no. 6. — Pp. 2558–2564.
615. Abele, J. C. Transient photoconductivity measurements in semi-insulating GaAs. II. A digital approach / J. C. Abele, R. E. Kremer, J. S. Blakemore // *J. Appl. Phys.* — 1987. — Sep. — Vol. 62, no. 6. — Pp. 2432–2438.
616. Mircea, A. A study of electron traps in vapour-phase epitaxial GaAs / A. Mircea, A. Mitonneau // *Applied physics.* — 1975. — Sep. — Vol. 8, no. 1. — Pp. 15–21.

617. Колченко, Т.И. Новый метастабильный центр в облученном GaAs / Т.И. Колченко, В.М. Ломако // *Физика и техника полупроводников.* — 1994. — Т. 28, № 5. — С. 857–860.
618. Pons, D. Irradiation-induced defects in GaAs / D. Pons, J. C. Bourgois // *J. Phys. C: Solid State Phys.* — 1985. — Jul. — Vol. 18, no. 20. — Pp. 3839–3871.
619. Самойлов, Б. А. Влияние изовалентной примеси сурьмы на образование электрически активных центров в n-GaAs, полученном жидкофазной эпигексией из расплава висмута / Б. А. Самойлов, Н. А. Якушева, В. Я. Прини // *Физика и техника полупроводников.* — 1994. — Т. 28, № 9. — С. 1617–1626.
620. Martin, G. M. Electron traps in bulk and epitaxial GaAs crystals / G. M. Martin, A. Mitonneau, A. Mircea // *Electronics Letters.* — 1977. — March. — Vol. 13, no. 7. — Pp. 191–193.
621. Study of defects in LEC-grown undoped Si-GaAs by thermally stimulated current spectroscopy / Zhaoqiang Fang, Lei Shan, T.E. Schlesinger, A.G. Milnes // *Materials Science and Engineering: B*. — 1990. — Feb. — Vol. 5, no. 3. — Pp. 397–408.
622. Non-extrinsic conduction in semi-insulating gallium arsenide / A. Ashby, G.G. Roberts, D.J. Ashen, J.B. Mullin // *Solid State Commun.* — 1976. — Oct. — Vol. 20, no. 1. — Pp. 61–63.
623. Fang, Zhao-Qiang. Evidence for EL6 ($E_c = 0.35$ eV) acting as a dominant recombination center in n-type horizontal Bridgman GaAs / Zhao-Qiang Fang, T. E. Schlesinger, A. G. Milnes // *J. Appl. Phys.* — 1987. — Jun. — Vol. 61, no. 11. — Pp. 5047–5050.
624. Определение параметров глубоких центров в полупроводнике GaAs по релаксации фотопроводимости при лазерном возбуждении / Ю. Вайкус, Ю. Стората, А. Пинцевич и др. // *Литовский физический сборник.* — 1988. — Т. 28, № 6. — С. 744–751.

625. *Lin, Alice L.* Photoelectronic properties of high-resistivity GaAs:O / Alice L. Lin, Eric Omelianovski, Richard H. Bube // *J. Appl. Phys.* — 1976. — May. — Vol. 47, no. 5. — Pp. 1852–1858.
626. *Morrow, Richard A.* In-diffusing divacancies as sources of acceptors in thermally annealed GaAs / Richard A. Morrow // *J. Appl. Phys.* — 1991. — Mar. — Vol. 69, no. 5. — Pp. 3396–3398.
627. *Lefèvre, H.* Double correlation technique (DDLTS) for the analysis of deep level profiles in semiconductors / H. Lefèvre, M. Schulz // *Applied physics*. — 1977. — Jan. — Vol. 12, no. 1. — Pp. 45–53.
628. Особенности дефектообразования в эпитаксиальном арсениде галлия, содержащем изолированную примесь индия / Т.И. Кольченко, В.М. Ломако, А.В. Родионов, Ю.Н. Свешников // *Физика и техника полупроводников*. — 1989. — Т. 23, № 4. — С. 626–629.
629. *Nozariabmarz, Amin.* Field induced decrystallization of silicon: Evidence of a microwave non-thermal effect / Amin Nozariabmarz, Kelvin Dsouza, Daryoosh Vashaee // *Appl. Phys. Lett.* — 2018. — Feb. — Vol. 112, no. 9. — P. 093103.
630. Об особенностях модификации дефектной структуры в бинарных полупроводниках под действием микроволнового облучения / И.Б. Ермолович, Г.В. Миленин, Б.В. Миленин и др. // *Журнал технической физики*. — 2007. — Т. 77, № 9. — С. 71–75.
631. *Singh, A.* Reverse I-V and C-V characteristics of Schottky barrier type diodes on Zn doped InP epilayers grown by metalorganic vapor phase epitaxy / A. Singh, P. Cova, R. A. Masut // *J. Appl. Phys.* — 1994. — Aug. — Vol. 76, no. 4. — Pp. 2336–2342.
632. Дистокационное происхождение и модель избыточно–туннельного тока в p – n -структурах на основе GaP / В.В. Евстропов, М. Джумаева, Ю.В. Жильев и др. // *Физика и техника полупроводников*. — 2000. — Т. 34, № 11. — С. 1357–1362.

633. Statistics on Applied Voltages in Schottky Barrier Diodes at Same Forward Current in a Fabrication Process / K. Zhang, H. D. Zhao, H. S. Ahmed, M. Sun // *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*. — 2017. — Feb. — Vol. 30, no. 1. — Pp. 86–89.
634. *Tseng, Hsun-Hua.* A simple technique for measuring the interface-state density of the Schottky barrier diodes using the current–voltage characteristics / Hsun-Hua Tseng, Ching-Yuan Wu // *J. Appl. Phys.* — 1987. — Jan. — Vol. 61, no. 1. — Pp. 299–304.
635. *Аскеров, И.Г.* Влияние степени неоднородности границы раздела на электропроводящие свойства структур металл – вакуум и металл – полупроводник: Ph.D. thesis / Баку. — 1999. — 399 с.
636. Analysis of GaAs Schottky/tunnel metal-insulator-semiconductor diode characteristics based on an interfacial layer model / Hideaki Ikoma, Toshiki Ishida, Kenji Sato et al. // *J. Appl. Phys.* — 1993. — Feb. — Vol. 73, no. 3. — Pp. 1272–1278.
637. *Островский, И. В.* Отжиг точечных дефектов ультразвуком в твердых телах / И. В. Островский, О. А. Коротченков, В. А. Лысых // *Физика твердого тела*. — 1987. — Т. 20, № 7. — С. 2153–2156.
638. *Ozbek, A. Merve.* Tunneling coefficient for GaN Schottky barrier diodes / A. Merve Ozbek, B. Jayant Baliga // *Solid-State Electron.* — 2011. — Aug. — Vol. 62, no. 1. — Pp. 1–4.
639. Mechanism of carrier transport through a silicon–oxide layer for indium–tin–oxide/silicon–oxide/silicon solar cells / H. Kobayashi, T. Ishida, Y. Nakato, H. Mori // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Sep. — Vol. 78, no. 6. — Pp. 3931–3939.
640. Second-order generation of point defects in gamma-irradiated float-zone silicon, an explanation for «type inversion» / I. Pintilie, E. Fretwurst, G. Lindström, J. Stahl // *Appl. Phys. Lett.* — 2003. — Mar. — Vol. 82, no. 13. — Pp. 2169–2171.
641. Effect of Si nanoparticles on electronic transport mechanisms in P-doped silicon-rich silicon nitride/c-Si heterojunction devices / Deng-Hao Ma,

- Wei-Jia Zhang, Rui-Ying Luo et al. // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2016. — Aug. — Vol. 50. — Pp. 20–30.
642. Temperature dependence of the current–voltage characteristics of Sn/PANI/p–Si/Al heterojunctions / M. Kaya, H. Çetin, B. Boyarbay et al. // *J. Phys.: Condens. Matter.* — 2007. — Oct. — Vol. 19, no. 40. — P. 406205.
643. *Першинков, В.С. Поверхностные радиационные эффекты в элементах интегральных микросхем / В.С. Першинков, В.Д. Попов, А.В. Шальнов. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 256 с.*
644. Devine, R. A. B. The structure of SiO_2 , its defects and radiation hardness / R. A. B. Devine // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 1994. — Jun. — Vol. 41, no. 3. — Pp. 452–459.
645. Lenahan, P. M. What can electron paramagnetic resonance tell us about the Si/SiO₂ system? / P. M. Lenahan, J. F. Conley Jr. // *J. Vac. Sci. Technol. B*. — 1998. — Jul. — Vol. 16, no. 4. — Pp. 2134–2153.
646. Cantin, J. L. Irradiation effects in ultrathin Si/SiO₂ structures / J. L. Cantin, H. J. von Bardeleben, J. L. Autran // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 1998. — Jun. — Vol. 45, no. 3. — Pp. 1407–1411.
647. On the generation and recovery of interface traps in MOSFETs subjected to NBTI, FN, and HCI stress / S. Mahapatra, D. Saha, D. Varghese, P. B. Kumar // *IEEE Trans. Electron Devices*. — 2006. — July. — Vol. 53, no. 7. — Pp. 1583–1592.
648. Esseni, D. On interface and oxide degradation in VLSI MOSFETs. I. Deuterium effect in CHe stress regime / D. Esseni, J. D. Bude, L. Selmi // *IEEE Trans. Electron Devices*. — 2002. — Feb. — Vol. 49, no. 2. — Pp. 247–253.
649. Schroder, Dieter K. Negative bias temperature instability: Road to cross in deep submicron silicon semiconductor manufacturing / Dieter K. Schroder, Jeff A. Babcock // *J. Appl. Phys.* — 2003. — Jul. — Vol. 94, no. 1. — Pp. 1–18.
650. Парчинский, П.Б. Влияние γ -облучения на характеристики границы раздела кремний–свинцово–боросиликатное стекло / П.Б. Парчинский, С.И. Власов, А.А. Насиров // *Физика и техника полупроводников*. — 2004. — Т. 38, № 11. — С. 1345–1348.
651. Electrical probing of surface and bulk traps in proton-irradiated gate-assisted lateral PNP transistors / G. Niu, G. Banerjee, J. D. Cressler et al. // *IEEE Trans. Nucl. Sci.* — 1998. — Dec. — Vol. 45, no. 6. — Pp. 2361–2365.
652. Recovery behaviour resulting from thermal annealing in n-MOSFETs irradiated by 20 MeV protons / K. Takakura, H. Ohyama, A. Ueda et al. // *Semicond. Sci. Technol.* — 2003. — Jun. — Vol. 18, no. 6. — Pp. 506–511.
653. Würzer, H. Annealing of degraded npn-transistors-mechanisms and modeling / H. Würzer, R. Mahnkopf, H. Klöse // *IEEE Trans. Electron Devices*. — 1994. — Apr. — Vol. 41, no. 4. — Pp. 533–538.
654. Aziz, Michael J. Stress effects on defects and dopant diffusion in Si / Michael J. Aziz // *Mater. Sci. Semicond. Process.* — 2001. — Oct. — Vol. 4, no. 5. — Pp. 397–403.
655. DiMaria, D. J. Mechanism for stress-induced leakage currents in thin silicon dioxide films / D. J. DiMaria, E. Cartier // *J. Appl. Phys.* — 1995. — Sep. — Vol. 78, no. 6. — Pp. 3883–3894.
656. Gilmore, Angelo Scotty. I-V modeling of current limiting mechanisms in HgCdTe FPA detectors / Angelo Scotty Gilmore, James Bangs, Amanda Gerrish // *Proc. SPIE*. — 2004. — Vol. 5563. — Pp. 46–54.
657. Gopal, V. Excess dark currents in HgCdTe p⁺–n junction diodes / V. Gopal, S. K. Singh, R. M. Mehra // *Semicond. Sci. Technol.* — 2001. — May. — Vol. 16, no. 5. — Pp. 372–376.